

**ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ  
К ЖУРНАЛУ «ФИЗИКА И ТЕХНИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВ»  
Том 26, 1992 год**

- Абакумов В. Н., Резников Б. И., Царенков Г. В. Циркулярный фотогальванический эффект в гетероваризонной структуре. 2, 284
- Абдуллаев М. А. Экситонная структура края фундаментального поглощения  $\text{CuInSe}_2$ . 12, 2131
- Абдураимов А., Зайнабидинов С. З., Тешабаев А., Маматкаримов О. О., Химматкуллов О. Механизм тензоэффекта в  $n$ - $\text{Si}(\text{Mn})$  при всестороннем гидростатическом сжатии. 10, 1845
- Аблязимова Н. А., Вейнгер А. И., Питанов В. С. Влияние сильного СВЧ поля на фотоэлектрические характеристики кремниевых  $p$ - $n$ -переходов. 6, 1041
- Абрамов А. А., Захарикова Л. П., Микуленок А. В., Стоянова И. Г. Распределение концентрации мелких и глубоких заряженных центров в ионно-легированных бериллием слоях фосфида индия. 3, 500
- Абрамов В. В., см. Кульбачинский В. А. 10, 1801
- Абрамов В. В., Кульбачинский В. А., Кытин В. Г., Тимофеев А. Б., Ульяшин А. Г. Низкотемпературная электропроводность ионно-имплантированного фосфором и сурьмой кремния. 5, 878
- Абрамян Ю. А., Папазян К. З., Стафеев В. И. О влиянии индия на энергетический спектр  $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}$ . 2, 257
- Абуталыбов Г. И., Джафарова С. З., Рагимова Н. А., Мехтиев Э. И. Экситонные внутрицентровые и структурно-дефектные переходы в квазидвумерных кристаллах  $\text{TlGaS}_2:\text{Nd}_2\text{S}_3$ . 9, 1643
- Аверкиев Н. С., Гуткин А. А., Осипов Е. Б., Рещико М. А., Соновский В. Р. Симметрия комплекса  $\text{VGaTe}_2$  в  $\text{GaAs}$  и его переориентация при низких температурах. 7, 1269
- Аверьянов В. Л., Звонарева Т. К., Любин В. М. Электрические свойства контакта модифицированный-немодифицированный стеклообразный  $\text{As}_2\text{Se}_3$ . 5, 918
- Аверьянов И. С., см. Трифонова М. М. 7, 1327
- Аврутин Е. А., Корольков В. И., Орлов Н. Ю., Рожков А. В., Султанов А. М. Динамические характеристики мощных импульсных  $\text{GaAs}/\text{AlGaAs}$ -суперлюминесцентных светодиодов. 4, 719
- Авруцкий И. А., Осауленко О. П., Плотниченко В. Г., Пырклов Ю. Н. Определение однородности квантовых ям на основе  $\text{InGaAs}/\text{GaAs}$  по фотомодуляционным спектрам. 11, 1907
- Автюшков Е. В., см. Бумай Ю. А. 7, 1306
- Аджаров Г. Х., Кязымзаде Р. З., Мирбагиров В. В. Акцепторные уровни замещающих атомов примеси меди в кристаллах  $\text{Ge}_{1-x}\text{Si}_x$ . 3, 553
- Айвазов А. А., Будагян Б. Г., Мейтин М. Н., Становов О. Н. Влияние структурной неоднородности на проводимость и релаксационные процессы в  $\alpha\text{-Si}:\text{H}$  и  $\alpha\text{-Si}_{1-x}\text{N}_x$ :H. 9, 1585
- Айдаралиев М. Ш., Зегря Г. Г., Зотова Н. В., Карандашев С. А., Матвеев Б. А., Стусь Н. М., Талалакин Г. Н. Природа температурной зависимости пороговой плотности тока и длинноволновых лазеров на основе ДГС  $\text{InAsSbP}/\text{InAs}$  и  $\text{InAsSbP}/\text{InAsSb}$ . 2, 246
- Акимов А. А., Албул А. В., Богданов Е. В., Ильин В. Ю. Вольт-амперные характеристики и эффект переключения в низкоомное состояние в  $\text{PbTe}(\text{Ga})$  при низких температурах. 7, 1300
- Акопян А. А., Витусевич С. А., Гуга К. Ю., Малютенко В. К., Рыбак А. М. Контактная эксклюзия в полупроводниках с анизотропной биполярной проводимостью. 2, 389
- Акчурин Р. Х., Жегалин Б. А., Чалдышев В. В. Электрические и фотолюминесцентные свойства эпитаксиальных слоев  $\text{GaSb}(\text{Bi})$  и  $\text{GaSb}(\text{Bi}, \text{Sn})$ , полученных из висмутовых растворов. 8, 1409
- Албул А. В., см. Акимов Б. А. 7, 1300
- Александров О. В., Шевченко Б. Н., Махтанова И. П., Каменец А. В. Влияние радиационных дефектов, введенных  $\alpha$ -частицами, на обратные токи кремниевых  $p$ - $n$ -переходов. 5, 868
- Алексеева Г. Т., Земсков Б. Г., Константинов П. П., Прокофьева Л. В., Уразбаева К. Т. Роль дефектов в акцепторном легировании полупроводников типа  $\text{PbTe}$  элементами I группы. 2, 358

- Алексееенко М. В., см. Забродский А. Г. 3, 431
- Алешкин В. Я., Аншон А. В., Бабушкина Т. С., Батукова Л. В., Демидов Е. В., Звонков Б. Н., Кунцевич Т. С., Малкина И. Г., Янькова Т. Н. Межподзонное поглощение ИК излучения в напряженных структурах  $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As} - \text{GaAs}$  с квантовыми ямами. 3, 516
- Алешкин В. Я., Аншон А. В., Бутакова Л. М., Демидов Е. В., Демидова Е. Р., Звонков Б. Н., Карпович И. А., Малкина И. Г. Фотолуминесценция в  $\delta$ -легированных углеродом сверхрешетках в арсениде галлия. 10, 1848
- Алешкин В. Я., см. Карпович И. А. 11, 1886
- Алешкин В. Я., Костин А. А., Романов Ю. А. Температурная зависимость энергии связи экситонов Ваннье — Мотта в квантовых ямах. 2, 318
- Алимов О. М., Петров В. В., Харченко Т. Д., Явид В. Ю. Влияние редкоземельных элементов на энтропию и энтропию ионизации радиационных дефектов в германии, легированном фосфором. 11, 1914
- Аллахвердиев К. Р., см. Исмаилов А. А. 11, 1995
- Алфёров Ж. И., Егоров А. Ю., Жуков А. Е., Иванов С. В., Копьев П. С., Леденцов Н. Н., Мельцер Б. Я., Устинов В. М. Выращивание квантовых кластеров GaAs — AlAs на ориентированных не по (100) фасетированных поверхностях GaAs методом молекулярно-пучковой эпитаксии. 10, 1715
- Амальская Р. М., Баграев Н. Т., Клячкин Л. Е., Суханов В. Л. Геттерирование в кремнии в условиях генерации вакансий. 6, 1004
- Амиров Р. Х., Зудеев О. Г. Внутризонное излучение электронов в высокочастотном поле и неравновесные фононы. 4, 592
- Андреев А. Г., см. Зародский А. Г. 3, 431
- Андреев Б. А., Козлов Е. Б., Лившиц Т. М. Силы осцилляторов оптических переходов в мелких примесях и примесных комплексах в кремнии и германии. 5, 927
- Андроник К. И., Бойко М. П., Григорич А. В. Влияние примеси индия на электрофизические свойства  $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}$  при  $x > 0.3$ . 5, 839
- Андрухив А. М., Гадаев О. А., Иванов — Омский В. И., Миронов К. Е., Смирнов В. А., Юлдашев Ш. У., Цидильковский Э. И. Фотолуминесценция эпитаксиальных слоев  $\text{Zn}_x\text{Cd}_y\text{Hg}_{1-x-y}\text{Te}$ . 7, 1288
- Андрухив М. Г., Белотелов С. В., Вирт И. С., Шкумбатьюк П. С. Шум дефектов обратно смещенных  $n^+ - p$ -переходов на основе  $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$ . 2, 393
- Андрухив М. Г., Григорович Г. М., Бочкарева Л. В., Хляп Г. М., Шкумбатьюк П. С. Гетеропереходы  $\text{ZnTe} - \text{PbS}$ . 4, 761
- Анохина С. П., см. Котельников И. Н. 8, 1462
- Аншон А. В., см. Алешкин В. Я. 3, 516
- Аншон А. В., см. Алешкин В. Я. 10, 1848
- Аншон А. В., см. Карпович И. А. 11, 1886
- Апсит А. Р. Возникновение нормального электрического поля при ускоренном дрейфовом движении носителей заряда в полупроводнике с постоянным током. 10, 1850
- Арзикулов Э. У., см. Бахадырханов М. К. 9, 1536
- Аронзон Б. А., Дричко И. Л. Переход металл — диэлектрик в магнитном поле в сильно легированном антимониде индия. 8, 1446
- Артамонов В. В., Валах М. Я., Громашевский В. Л., Нечипорук Б. Д., Стрельчук В. В., Юхимчук В. А. Спектроскопия КРС ионно-имплантированных слоев GaAs. 4, 725
- Артамонов В. В., Валах М. Я., Денисов А. В., Мордкович В. Н., Нечипорук Б. Д. Воздействие света на процесс имплантации ионов  $\text{P}^+$  в Si. 12, 2083
- Арутюнян В. М., Варданян С. Х., Димаксян М. Л., Маргарян А. Л., Меликсетян В. А., Саруханян Р. Э. О возможности обнаружения поверхностных состояний из спектров фотопроводимости. 3, 550
- Арушанов Э. К., Рознован Ю. В., Шубников М. Л., Смирнов Д. В., Машовец Д. В. Осцилляция Шубникова — де Гааза в  $p\text{-ZnSb}$ . 2, 395
- Арцимович М. В., см. Сорока В. И. 9, 1547
- Асеров Б. М., Кулиев Б. И., Панахов М. М. Магнитосопротивление сверхрешеток в сильных полях. 4, 755
- Асланов Г. К., Тагиев О. Б., Иззатов Б. М. Изотермические термоактивационные токи в монокристаллах  $\text{CaGa}_2\text{S}_4$ . 4, 703
- Ахмедова Ф. И., см. Трифонова М. М. 7, 1327
- Бабаходжаев У. С., см. Голикова О. А. 1, 66
- Бабенцов В. Н., Горбань С. И., Евтухов Ю. Н. Низкотемпературная фотолуминесценция монокристаллических слоев  $\text{Zn}_x\text{Cd}_{1-x}\text{Te}$ , полученных твердофазным замещением. 6, 1063
- Бабенцов В. Н., Рашковецкий Л. В., Сальков Е. А., Тарбаев Н. И. Исследование преобразования дефектов в кристаллах CdTe при кратковременном отжиге методом люминисцентного профилирования. 6, 1088
- Бабич В. М., Баран Н. П., Доценко Ю. П., Зотов К. И., Ковальчук В. Б., Максименко В. М. Образование и свойства термодоноров при отжиге ниже 550 °C в кристаллах кремния, выращенных по методу Чохральского. 3, 447
- Бабичев Г. Г., Гузь В. Н., Жадько И. П., Козловский С. И., Романов В. А. Исследование биполярного двухколлекторного тензотранзистора с ускоряющим электрическим полем в базе. 7, 1244
- Бабичев Г. Г., Гузь В. Н., Жадько И. П., Козловский С. И., Романов В. А. Перераспределение концентрации инжектированных носителей заряда в искусственно анизотропной полупроводниковой

- пластине с кольцевыми электродами. 10, 1723
- Бабушкина Т. С., см. Алешкин В. Я. 3, 516
- Баграев Н. Т., см. Амальская Р. М. 6, 1004
- Баграев Н. Т., Мирсаатов Р. М., Половцев И. С., Сирохов У., Юсупов А. Метастабильность центров марганца в твердых растворах кремний—германий. 3, 427
- Баграев Н. Т., Мирсаатов Р. М., Половцев И. С., Юсупов А. Цинк в кремнии: фотоиндуцированные реакции. 3, 481
- Баграев Н. Т., Мирсаатов Р. М., Половцев И. С., Сирохов У., Юсупов А.  $Si_{1-x}Ge_x$  самокомпенсация двойных акцепторов цинка в твердых растворах кремний—германий. 5, 836
- Байдудлаева А., Булах Б. М., Даулетмуратов Б. К., Джумаев Б. Р., Корсунская Н. Е., Мозоль П. Е., Гарягдыев Г. Влияние дислокаций, образованных лазером облучения, на электрофизические и люминесцентные свойства  $p$ -CdTe. 5, 801
- Байдусь Н. В., см. Бедный Б. И. 8, 1383
- Байдусь Н. В., см. Бедный Б. И. 11, 1984
- Байдусь Н. В., см. Карпович И. А. 11, 1886
- Бакуева Л. Г., Захарова И. Б., Ильин В. И., Мисухин С. Ф. Влияние структуры и фазового состава на фотоэлектрические характеристики пленок  $Pb_{1-x}Sn_xS(Na)$ . 11, 2011
- Бакши И. С., Карачевцева Л. А., Любченко А. В., Петряков В. А., Салыков Е. А., Хижняк Б. И. Влияние компенсирующего отжига на шум  $1/f$  в  $Cd_xHg_{1-x}Te$ . 1, 173
- Баран Н. П., см. Бабиц В. М. 3, 447
- Баранов А. Н., Белкин С. Ю., Данилова Т. Н., Ершов О. Г., Именков А. Н., Яковлев Ю. П. Природа длинноволнового сдвига спектра когерентного излучения в гетеролазерах на основе  $GaNAsSb$ . 11, 1971
- Баранов А. Н., Воронина Т. И., Гореленок А. А., Лагунова Т. С., Литвак А. М., Сиповская М. А., Старосельцева С. П., Тихомирова В. А., Шерстнев В. В. Исследование структурных дефектов в эпитаксиальных слоях арсенида индия. 9, 1612
- Барышев Н. С., см. Трифонова М. М. 7, 1327
- Басс Ф. Г., Булгаков А. А., Ханкина С. И. Особенности распространения „внутренних“ электростатических волн в неоднородной плазмоподобной среде. 1, 140
- Батукова Л. М., см. Алешкин В. Я. 3, 516
- Батукова Л. М., см. Алешкин В. Я. 10, 1848
- Батукова Л. М., см. Карпович И. А. 11, 1886
- Бахадурханов М. К., Зикриллаев Н. Ф., Арзикулов Э. У. Низкочастотные колебания тока в компенсированном цинком кремнии. 9, 1536
- Бахматюк Б. П., см. Козымяк И. Д. 11, 1993
- Бегер В. Н., Земский В. И., Сечкарев А. В. Спектры испускания силикатного пористого стекла, возбуждаемые лазерным излучением в области прозрачности  $SiO_2$ . 5, 911
- Бегучев В. П., Мечетин А. М., Кондратьева О. Г., Неустроев Л. Н. О новом токе и шум-факторе ступенчатых ЛФД. 7, 1236
- Бедный Б. И., Байдусь Н. В., Белич Т. В., Карпович И. А. Влияние сульфидирования на состояние поверхности и фотоэлектрические свойства  $InP$  и  $GaAs$ . 8, 1383
- Бедный Б. И., Суслов Л. А., Байдусь Н. В., Карпович И. А. Электронные состояния поверхности  $InP$ , модифицированной обработкой в парах серы. 11, 1984
- Белич Т. В., см. Бедный Б. И. 8, 1383
- Белкин С. Ю., см. Баранов А. Н. 11, 1971
- Белоконь С. А., Верещагина Л. Н., Иванчик И. И., Рябова Л. И., Хохлов Д. Р. Характер изменения свойств  $PbTe(Ga)$  при изменении степени легирования. 2, 264
- Белотелов С. В., см. Андрухив М. Г. 2, 393
- Белотелов С. В., см. Вирт И. С. 3, 565
- Беляевский В. И., Капустин Ю. А., Свиридов В. В. Интерпретация неравновесных емкостных спектров  $A$ -центров, вводимых при импульсной фотонной обработке кремния. 10, 1832
- Беляев А. П., Рубец В. П., Тошходжаев Х. А. Процессы токопереноса в гетероструктуре  $In_2O_3-ZnSe-In$  с субмикронным слоем селенида цинка. 5, 935
- Беляев А. П., Рубец В. П., Тошходжаев Х. А., Калинин И. П. Инжекционно-контактные явления в гетероструктуре на основе неупорядоченного селенида цинка. 10, 1755
- Бердинских Т. Г., см. Торчинская Т. В. 3, 454
- Березина А. В., Житинская М. К., Немов С. А., Черник И. А. Примесные состояния  $In$  в  $GeTe$ . 8, 1405
- Беркович В. Л., Гусев А. О., Львова Т. В. Анизотропия оптического отражения арсенида галлия в области края фундаментального поглощения. 7, 1264
- Берман Л. С., Воронков В. Б., Козлов В. А., Ременюк А. Д. О механизме отжига дивакансий в кремнии, облученном протономми. 8, 1507
- Берча А. И., см. Бобицкий Я. В. 10, 1688
- Бесман В. Б., см. Гусев Г. М. 3, 539
- Бильгильдеева Т. Ю., Полянская Т. А. Квантовые когерентные эффекты в германии, легированном мышьяком. 6, 1109
- Блажку А. И., Джуади Д., Касиян В. А., Мосейчук Г. С., Недеогло Д. Д. Кинетические свойства кристаллов  $n-ZnSe$  с радиационными дефектами. 5, 900
- Блохин И. К., Холоднов В. А. О влиянии неоднородности поглощения сигнального излучения на частотную характеристику высокомерного примесного фоторезистора. 4, 742
- Бобицкий Я. В., Берча А. И., Дмитрук Н. Л., Корбутяк Д. В., Фидря Н. А. Исследование лазерного геттерирования в  $GaAs$  методами фотолюминесценции и нарушенного полного внутреннего отражения. 10, 1688
- Богданов Е. В., см. Акимов Б. А. 7, 1300
- Богданова В. А., Семиколосова Н. А. Фотолюминесценция сильно легированного

- арсенида галлия при упорядоченном распределении примесных комплексов. 5, 818
- Боднарук О. А., Горбатюк И. Н., Остапов С. Э., Раренко И. М. Концентрация собственных носителей и эффективная масса электронов в  $\text{Pb}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$ . 3, 468
- Божевольнов В. Б., см. Яфясов А. М. 4, 636
- Бойко М. П., см. Андроник К. И. 5, 839
- Бойко М. П., Засавицкий Е. А. Низкотемпературные аномалии термоэдс  $\text{PbTe}(\text{Te})$ . 3, 568
- Бойцов С. К., см. Вуль А. Я. 1, 111
- Бойцов С. К., см. Вуль А. Я. 1, 146
- Бойцов С. К., см. Вуль А. Я. 2, 295
- Бокачева Л. С., Гальперин Ю. М. Акустоэлектрический эффект в системах с локализованным состоянием в режиме моттовской проводимости. 11, 2003
- Болотов В. В., Плотников Г. Л., Эмексузян В. М., Шмальц К. Пассивация радиационных дефектов в гидрогенизированных слоях кремния при нейтронном облучении. 7, 1295
- Бондаренко И. Е., см. Выборнов В. В. 12, 2076
- Бондарь Н. В., см. Коваленко А. В. 7, 1251
- Борисов В. И., Гореленок А. Т., Дмитриев С. Г., Любченко В. Е., Рехвиашвили Д. Н., Рогашков А. С. Диоды Ганна на основе гетероструктуры  $\text{InGaAs}/\text{n}^+-\text{InP}$ . 4, 611
- Бочкарева Л. В., см. Андрухов М. Г. 4, 761
- Бочкарева Н. И., Рувимов С. С. О природе «аномальных» DLTS-спектров в монокристаллах германия с дислокациями. 5, 872
- Брандт Н. Б., Скипетров Е. П., Хорош А. Г. Резонансная зона радиационных дефектов в сплаве  $p\text{-Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}$  ( $x=0.2$ ), облученном электронами. 5, 888
- Бреслер М. С., см. Гусев О. Б. 4, 738
- Бринкевич Д. И., Маркевич В. П., Мурин Л. И., Петров В. В. Кинетика образования термодоноров в кристаллах  $\text{Si}(\text{Ge}, \text{O})$ . 4, 682
- Бродовой А. В., см. Лашкарев Г. В. 10, 1768
- Бродовой А. В., см. Лашкарев Г. В. 10, 1825
- Будагян Б. Г., см. Айвазов А. А. 9, 1585
- Буданцев М. В., Квон З. Д., Погосов А. Г. Отрицательное продольное магнитосопротивление  $\delta$ -легированных слоев  $\text{GaAs}$ . 9, 1565
- Булах Б. М., см. Байдуллаева А. 5, 801
- Булагов А. А., см. Басс Ф. Г. 1, 140
- Бумай Ю. А., Малаховская В. Э., Ульшин А. Г., Шлопак Н. В., Самойлюк Т. Т., Никитина Т. Д., Горуца К. С., Автюшков Е. В. Влияние двойной имплантации атомов кремния и фтора на электрофизические параметры полупроводящего арсенида галлия. 7, 1306
- Бумяляне С., Яссиевич И. Н. Захват электронов на отталкивающие кулоновские центры в германии. 9, 1569
- Бурлак А. В., Зотов В. В., Игнатов А. В., Тюрин А. В., Цукерман В. Г. Особенности электрофизических характеристик
- тонких слоев  $\text{PbS}$  с низким содержанием окислителя. 3, 548
- Буянов А. В., Гасан-заде С. Г., Жадько И. П., Зинченко Э. А., Романов В. А., Фридрих Е. С., Шепельский Г. А. Оптический эффект зависимости фотопроводимости и фотоманнитного эффекта в эпитаксиальных слоях  $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}/\text{CdTe}$  с анодно-окисленной свободной поверхностью. 4, 629
- Бычкова Л. П., Давариашвили О. И., Шотов А. П. Анализ зависимости ширины запрещенной зоны от состава  $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Se}_{1-y}\text{Te}_y$  изопериодического с  $\text{PbSe}$ , в рамках  $p$ -модели. 2, 280
- Бычковский Д. Н., Воронцова Т. П., Константинов О. В. Контактный потенциал квантовой ямы в полупроводниковой гетероструктуре. 12, 2118
- Бычковский Д. Н., Константинов О. В. Влияние заряда, встроенного в изотипный гетеропереход, на вольффарданные характеристики барьерной структуры. 5, 921
- Бычковский Д. Н., Константинов О. В., Панахов М. М. Методика определения разрыва зон на гетерогранице по измерениям вольффарданных характеристик  $m$ - $s$ -гетероструктуры. 4, 653
- Вагидов Н. З., Грибников З. С. Баллистическая проводимость квантовой ямы с туннельно-резонансным отражателем. 12, 2068
- Ваксман Ю. Ф., см. Краснов А. Н. 6, 1151
- Ваксман Ю. Ф., см. Краснов А. Н. 11, 2001
- Валах М. Я., см. Артамонов В. В. 4, 725
- Валах М. Я., см. Артамонов В. В. 12, 2083
- Варданян С. Х., см. Арутюнян В. М. 3, 550
- Василевский К. В. Расчет динамических характеристик лавинно-пролетного диода на карбиде кремния. 10, 1775
- Васильев А. Э., см. Ильин Н. П. 11, 1866
- Васильев А. Э., см. Ильин Н. П. 11, 1878
- Васько Ф. Т. Релаксация фотовозбужденных электронов в двойных квантовых ямах. 5, 825
- Веденев А. С., Гайворонский А. Г., Ждан А. Г. Определение электронных характеристик границ раздела полупроводник—диэлектрик по полевым зависимостям электропроводности в емкости инверсионных каналов МДП транзисторов. 12, 2017
- Веденев А. С., Ждан А. Г., Рыльков В. В., Шафран А. Г. Определение сеенция фотоионизации легирующих примесей в полупроводниках из измерений эффекта Холла. 6, 1096
- Вейнгер А. И., см. Аблязимова Н. А. 6, 1041
- Венгер Е. Ф., Гончаренко А. В., Дмитрук Н. Л., Прокофьев А. Ю., Фидра Н. А. Влияние ионной имплантации компенсирующей примеси на оптические свойства  $\text{n}^+-\text{GaAs}$ . 2, 352
- Вербицкая Е. М., Еремин В. К., Иванов А. М., Строкан Н. Б. Глубокие уровни термодиффектов в высокоомном особо чистом  $n$ -кремнии. 11, 1962

- Бергелес М. В., Меркулов И. А. К теории захвата дырок квантовой ямой в полупроводниках типа GaAs. 10, 1784
- Веренчикова Р. Г., Водаков Ю. А., Литвин Д. П., Мохов Е. Н., Роенков А. Д., Санкин В. И. Ультрафиолетовые карбид-кремниевые фотоприемники. 6, 1008
- Верещагина Л. Н., см. Белоконь С. А. 2, 264
- Вертий А. А., Горбатьюк И. Н., Иванченко И. В., Попенко Н. А., Пустыльник О. Д., Раренко И. М., Тарапов С. И. Исследование объемных и поверхностных кинетических свойств кристаллов  $n\text{-Hg}_{1-x}\text{CdTe}$  в области температур  $0.5 < T < 50$  К. 4, 585
- Вильмс П. П., см. Гусев Г. М. 3, 539
- Винокуров Л. А., Залетаев Н. Б., Кочеров В. Ф., Фукс Б. И. Растекание нестационарного фототока в  $\text{Si}(\text{Ga})$ . 4, 770
- Вирт И. С., см. Андрухив М. Г. 2, 393
- Вирт И. С., Белотелов С. В. Свойства  $p^+$  —  $p$ -переходов на основе  $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$ , подвергнутых локальной деформации. 3, 565
- Вирт И. С., Кузьма М. С., Шерегий Е. М., Шкумбатьюк П. С. Твердотельное лазерное легирование монокристаллов  $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$ . 3, 562
- Де Виссер А., Иванчик И. И., Никорич А. В., Хохлов Д. Р. Локализация и дelokализация в  $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}$ , индуцированные сверхсильным магнитным полем и ИК подсветкой. 6, 1034
- Витусевич С. А., см. Акопян А. А. 2, 389
- Владимиров В. В., Горшков В. Н., Малютенко В. К. Хаотические автоколебания в варизонных полупроводниковых структурах. 9, 1580
- Водаков Ю. А., Гирка А. И., Константинов А. О., Мохов Е. Н., Роенков А. Д., Свирида С. В., Семенов В. В., Соколов В. И., Шишкин А. В. Светодиоды на основе карбида кремния, облученного быстрыми электронами. 11, 1857
- Водаков Ю. А., см. Веренчикова Р. Г. 6, 1008
- Водаков Ю. А., Вольфсон А. А., Зарицкий Г. В., Мохов Е. Н., Остроумов А. Г., Роенков А. Д., Семенов В. В., Соколов В. И., Сыралев В. А., Удайцов В. Е. Эффективные зеленые светоиды на карбиде кремния. 1, 107
- Вольфсон А. А., см. Водаков Ю. А. 1, 107
- Воронина Т. И., см. Баранов А. Н. 9, 1612
- Воронков В. Б., см. Берман Л. С. 8, 1507
- Воронков В. П., Колыгина В. М., Муленков С. Ю., Оборина Е. И., Сальман Е. Г., Смирнова Т. П. Влияние лазерного отжига на электрические характеристики МДП структур на основе GaAs. 6, 1120
- Воронцова Т. П., см. Бычковский Д. Н. 12, 2118
- Вуль А. Я. Рецензия на книгу Федотова Я. А. «Интегральная электроника сверхвысоких частот». 6, 1156
- Вуль А. Я., Дидейкин А. Т., Бойцов С. К., Зинчик Ю. С., Саченко А. В. Эффект усиления фототока в структурах полупроводник—туннельно-прозрачный диэлектрик—полупроводник. 2, 295
- Вуль А. Я., Дидейкин А. Т., Осипов В. Ю., Бойцов С. К., Зинчик Ю. С., Макарова Т. Л. Вольтамперные характеристики кремниевых ПДП структур с толщиной диэлектрика менее 50 ангстрем. 1, 146
- Вуль А. Я., Макарова Т. Л., Осипов В. Ю., Зинчик Ю. С., Бойцов С. К. Кинетические окисления кремния и структура окисных слоев толщиной менее 50 ангстрем. 1, 111
- Выборнов В. В., Бондаренко И. Е., Лихарев С. К., Трифоненков В. П. Реконструкция глубинной структуры микротрещин в кремнии с помощью метода томографии и наведенного тока в растровом электронном микроскопе. 12, 2076
- Вывенко О. Ф., Истратов А. А. Оптимизация корреляционной процедуры в методах термостимулированной релаксационной спектроскопии полупроводников. 10, 1693
- Вывенко О. Ф., см. Рыков В. В. 9, 1653
- Выжигин Ю. Ф., Соболев Н. А., Гресеров Б. Н., Шек Е. И. Влияние неравновесных собственных точечных дефектов на образование электрически активных центров в кремниевых  $p$ — $n$ -структурах при термообработке. 11, 1938
- Вязовский М. В., Крюков С. В. Радиозлектрический эффект в сверхрешетках в импульсном режиме облучения. 1, 184
- Гадаев О. А., см. Андрухив А. М. 7, 1288
- Гадаев О. А., см. Иванов-Омский В. И. 3, 413
- Гадаев О. А., см. Иванов-Омский В. И. 3, 420
- Гаджиалиев М. М. Магнитотермоздс  $\text{Mn}_{0.18}\text{Hg}_{0.82}\text{Te}$ . 5, 915
- Гаджиалиев М. М., Мусаев А. М. Магнитотермоздс  $\text{Mn}_{0.06}\text{Hg}_{0.94}\text{Te}$  при одноосной деформации. 11, 1952
- Гадияк Г. В., см. Качурин Г. А. 11, 1978
- Гайворовский А. Г., см. Веденев А. С. 12, 2017
- Галеев А. П., см. Крылов Д. Г. 7, 1347
- Гальперин Ю. М., см. Бочкарев Л. С. 11, 2003
- Гарягдыев Г., см. Байдуллаева А. 5, 801
- Гасан-заде С. Г., см. Буянов А. В. 4, 629
- Гасан-заде С. Г., Жадько И. П., Зинченко Э. А., Каленик В. И., Раренко И. М., Романов В. А., Шепельский Г. А. Характеристики фотопроводимости и фотомангнитного эффекта в кристаллах  $\text{Mn}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$  с анодно-окисленными поверхностями. 6, 1100
- Гасымов Ш. Г., см. Исмаилов А. А. 11, 1995
- Георгиц Е. И., Гуцуляк Л. М., Иванов—Омский В. И., Мастеров В. Ф., Смирнов В. А., Штельмах К. Ф. Структура примесного центра марганца в антимониде галлия. 1, 89

- Герасименко Н. Н., Мясников А. М., Ободников В. И., Сафронов Л. Н. Перераспределение магния в InAs при постимплантированном отжиге. 9, 1651
- Герасименко Н. Н., см. Чистохин И. Б. 9, 1529
- Гергель В. А., Ильичев Э. А., Лукьянченко А. И., Полторацкий Э. А., Шамхалов К. С. Паразитное управление по подложке в полевых транзисторах на арсениде галлия. 5, 794
- Гергель В. А., Тарнавский С. П. Туннельно-термическая переразрядка глубоких уровней в барьере Шоттки. I. Вольт-амперные характеристики. 7, 1330
- Гергель В. А., Тарнавский С. П. Туннельно-термическая переразрядка глубоких уровней в барьере Шоттки. II. Дисперсия малосигнальных характеристик. 7, 1335
- Германенко А. В., Ларионов В. А., Миньков Г. М., Рут О. Э. Пленка Ленгмюра—Блуджет в качестве диэлектрика в МДП транзисторе на основе  $Cd_xHg_{1-x}Te$ . 12, 2136
- Герчиков Л. Г., Субашиев А. В. Спиновое расщепление подзон размерного квантования в несимметричных гетероструктурах. 1, 131
- Герчиков Л. Г., Субашиев А. В., Далла Салман. Зонная структура короткопериодических сверхрешеток III типа. 5, 882
- Гиппиус А. А., см. Гукасян А. М. 3, 525
- Гирка А. И., см. Водаков Ю. А. 11, 1857
- Гитцович А. В., см. Соболев М. М. 10, 1760
- Гифейсман Ш. Н., Корочану В. П. Полярные параметры в полупроводниках с вырожденным краем валентной зоны. 5, 949
- Гладышук А. А., см. Грибковский В. П. 11, 1920
- Глинский Г. Ф., Лупал М. В., Парфенова И. И., Пихтин А. Н. Тонкая структура A-линии связанного экситона в твердом растворе  $GaAs_xP_{1-x}$ : N. 4, 644
- Голант Г. В., см. Пликус Ф. Г. 1, 59
- Голикова О. А. Икосаэдрические бориды и аморфный бор. 9, 1604
- Голикова О. А., Бабаходжаев У. С., Дубро В. В., Икрамов Р. Г., Казанин М. М., Мездрогина М. М., Яфаев Р. Р. Фотопроводимость и плотность состояний аморфного гидрированного кремния, легированного бором. 1, 66
- Голикова О. А., Икрамов Р. Г., Казанин М. М. Исследование электропереноса дырок в аморфном гидрированном кремнии методом фотоВАХ. 1, 71
- Голикова О. А., Мездрогина М. М., Соколов А. П., Шебагин А. П. Структурная сетка  $a-Si$ : H, легированного бором, и транспорт дырок. 6, 960
- Голикова О. А., Сорокина К. Л. Состояние оборванных связей в псевдолегированном аморфном гидрированном кремнии  $a-Si$ : H. 8, 1511
- Голубев В. Г., Емцев В. В., Клиnger П. М., Кропотов Г. И., Шмарцев Ю. В. Процессы образования радиационных дефектов в Si: Ge при 4.2, 78 и 300 К. 3, 574
- Гольдман Е. И. Определение пространственного расположения локализованных электронных состояний у границы раздела полупроводник—диэлектрик. 4, 766
- Гольдман Е. Н., Ждан А. Г., Сумарока А. М. Термическая генерация неосновных носителей заряда у границы раздела полупроводник—диэлектрик через глубокий уровень в приповерхностном слое обеднения. 12, 2048
- Гончаренко А. В., см. Венгер Е. Ф. 2, 352
- Горбань С. И., см. Бабенцов В. Н. 6, 1063
- Горбатько И. Н., см. Боднарук О. А. 3, 468
- Горбатько И. Н., см. Вертий А. А. 4, 585
- Гордеев Д. М., Шмагин В. В. Повышение разрешения в релаксационной спектроскопии глубоких уровней в двухканальным строб-интегратором. 5, 955
- Горев Н. Б., Костылев С. А., Макарова Т. В., Прохоров Е. Ф., Уколов А. Т. Вольт-фарадные характеристики тонкопленочных структур  $n-GaAs$ . 5, 861
- Горев Н. Б., Макарова Т. В., Прохоров Е. Ф., Уколов А. Т., Эппель В. И. Вольт-фарадные характеристики гетероструктур с селективным легированием при наличии глубоких центров. 7, 1339
- Гореленок А. А., см. Баранов А. Н. 9, 1612
- Гореленок А. Т., см. Борисов В. И. 4, 611
- Горичок И. Я., см. Фрейк Д. М. 12, 2103
- Городниченко О. К., Коваленко В. Ф., Прохорович А. В. Деформационно-стимулированное изменение концентрации излучающих центров в арсениде галлия. 4, 759
- Горуа К. С., см. Бумай Ю. А. 7, 1306
- Горфинкель В. Б., Филатов И. И. Высокочастотная модуляция выходной мощности полупроводникового лазера на двойной гетероструктуре  $n^+-AlCaAs-GaAs-p^+-AlCaAs$  греющим электрическим полем. 3, 401
- Горшков В. Н., см. Владимиров В. В. 9, 1580
- Горшкова О. В., Дрозд И. А., Стафеев В. И. Фотозлектрические свойства эпитаксиальных пленок  $Pb_{1-x}Sn_xS$  и структур на их основе, обусловленные микро- и макронеоднородностями. 3, 510
- Грек В. В. Статические характеристики тонкопленочных полевых транзисторов на основе  $a-Si$ : H. 7, 1256
- Грессеров Б. Н., см. Выжигин Ю. В. 11, 1938
- Грибковский В. П., Гладышук А. А., Гурский А. Л., Луценко Е. В., Морозова Н. К., Шульга Т. С., Яблонский Г. П. Кристаллографическая ориентация и примесное свечение стримерных разрядов в монокристаллах ZnS и ZnSe. 11, 1920
- Грибников З. С. Баллистическая электропроводность органического туннельного контакта двух квантовых ям. 6, 996
- Грибников З. С., см. Вагидов Н. З. 12, 2068
- Григорович Г. М., см. Андрухив М. Г. 4, 761
- Григорчак И. И., см. Козымик И. Д. 11, 1993

- Риньев С. Н., Чернышев В. Н. Рассеяние электронов в многобарьерных структурах GaAs/Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>As. 12, 2057
- Гродненский И. М., Дикаев Ю. М., Руденко А. С., Старостин К. В., Яссен М. Л., Медведев Б. К., Мокеров В. Г., Слепнев Ю. В. Множественная полосковая структура с квазидвумерным электронным энергетическим спектром. 9, 1521
- Грошаковский В. Л., см. Артамонов В. В. 4, 725
- Громовой Ю. С., Кадышев С. К., Пляцко С. В. Фотостимулированное изменение положения ионов Mn<sup>2+</sup> в кристаллической решетке селенида свинца. 12, 2098
- Громовой Ю. С., Пляцко С. В., Кадышев С. К. Положение и зарядовое состояние примеси европия в решетке селенида свинца. 4, 778
- Громовой Ю. С., см. Ройцин А. Б. 12, 2091
- Грязнов С. Б., см. Добровольский В. Н. 8, 1366
- Гуга К. Ю., см. Акопян А. А. 2, 389
- Гуга К. Ю., Илющенко И. Ю. Кинетика установления эксклюзии в  $p^+ - p$ -структурах Ge с наведенной магнитным полем анизотропной проводимостью. 12, 2146
- Гуга К. Ю., Малютенко В. К., Рыбак А. М. Неравновесное излучение при эксклюзии в полупроводниках с наведенной анизотропией проводимости. 12, 2141
- Гузь В. Н., см. Бабичев Г. Г. 7, 1244
- Гузь В. Н., см. Бабичев Г. Г. 10, 1723
- Гукасян А. М., Ушаков В. В., Гиппиус А. А., Марков А. В. Фотоиндуцированное образование центров поверхностной рекомбинации в арсениде галлия. 3, 525
- Гуревич С. А., Екимов А. И., Кудрявцев И. А., Осинский А. В., Скопина В. И., Челик Д. И. Получение и исследование пленок SiO<sub>2</sub>, активированных полупроводниковыми нанокристаллами CdS. 1, 102
- Гуревич Ю. Г., Логвинов Г. Н. Термоэдс и термоток монополярных полупроводников органических размеров. 11, 1945
- Гурский А. Л., см. Грибковский В. П. 11, 1920
- Гусаков Г. А., см. Новиков А. П. 10, 1841
- Гусев А. О., см. Берковиц В. Л. 7, 1264
- Гусев Г. М., Квон З. Д., Бесман В. Б., Вильмс П. П., Коваленко Н. В., Мошегов Н. Т., Торопов А. И. Осцилляции Шубникова—де-Гааза двумерного электронного газа в двумерном периодическом потенциале. 3, 539
- Гусев О. Б., Бреслер М. С., Зотова Н. В., Стусь Н. М. Переход от гетероструктур первого типа к гетероструктурам второго типа в системе InAs/InAsSbP. 4, 738
- Гусев О. К., Киреенко В. П., Яржембицкий В. Б. Аномальный фотохолл-эффект в кристаллах  $p$ -InAs. 6, 1138
- Гусинский Г. М., Дьяконова Н. В., Левинштейн М. Е., Румянцев С. Л. Шум  $1/f$  электрические и фотоэлектрические свойства GaAs, подвергнутого облучению ионами высокой энергии. 3, 543
- Даварашвили О. И., см. Бычкова Л. П. 2, 280
- Даварашвили О. И., Караваев Г. Ф., Катаев С. Г., Тютеров В. Г. Излучательная и безызлучательная рекомбинация в четверных твердых растворах Pb<sub>1-x</sub>Sn<sub>x</sub>Te. 5, 906
- Давыдов И. А., Страхов Л. П., Целищев С. Л. Роль объемных глубоких центров в формировании поверхностной фотоэдс в низкоомных монокристаллах ZnSe. 1, 159
- Далла Салман., см. Герчиков Л. Г. 5, 882
- Данилова Т. Н., см. Баранов А. Н. 11, 1971
- Дарчук С. Д., Коровина Л. А., Сизов Ф. Ф. Резонансные состояния в легированных и нелегированных кристаллах теллурида свинца. 5, 845
- Даулетмуратов Б. К., см. Байдуллаева А. 5, 801
- Демидов Е. В., см. Алешкин В. Я. 3, 516
- Демидов Е. В., см. Алешкин В. Я. 10, 1848
- Демидов Е. С., Карзанов В. В. О втором донорном уровне междоузельного хрома в кремнии. 9, 1656
- Демидов Е. С., см. Павлов П. В. 6, 1148
- Демидова Е. Р., см. Алешкин В. Я. 10, 1848
- Денисова А. В., см. Артамонов В. В. 12, 2083
- Дерябина Т. И., см. Завьялов В. В. 4, 691
- Джафарова С. З., см. Абуталыбов Г. И. 9, 1643
- Джобава Д. Ш., см. Карумидзе Г. С. 12, 2138
- Джуади Д., см. Блажку А. И. 5, 900
- Джуади Д., Касиян В. А., Недеогло Д. Д. Температурное гашение остаточной проводимости в кристаллах селенида цинка, легированных медью. 8, 1433
- Джумаев Б. Р., см. Байдуллаева А. 5, 801
- Джумаев Б. Р., см. Крюкова И. В. 6, 1054
- Джумамухамбетов Н. Г., Дмитриев А. Г. К вопросу о природе полосы излучения (1.23—1.25) эВ в спектре люминесценции кристаллов GaAs(Te). 5, 958
- Дидейкин А. Т., см. Вуль А. Я. 1, 146
- Дидейкин А. Т., см. Вуль А. Я. 2, 295
- Дикаев Ю. М., см. Гродненский И. М. 9, 1521
- Дикман С. М. О корреляционном механизме двухуровневой рекомбинации в  $\nu$ ,  $\epsilon$ -облученном кремнии. 8, 1427
- Димаксян М. Л., см. Арутюнян В. М. 3, 550
- Дмитриев А. Г., см. Джумамухамбетов Н. Г. 5, 958
- Дмитриев А. Г., Дорин В. А., Карфул Р., Погарский М. А., Шульга М. И. Образование глубоких центров в GaAs при лазерном облучении. 2, 397
- Дмитриев С. Г., см. Борисов В. И. 4, 611
- Дмитрук Н. Л., см. Бобичский Я. В. 10, 1688
- Дмитрук Н. Л., см. Венгер Е. Ф. 2, 352
- Добровольская А. М., см. Фрейк Д. М. 12, 2103
- Добровольский В. Н., Грязнов С. Б. Образование электронно-дырочных пар и

- лавинный пробой  $p-n$ -перехода при градиентах дрейфовых скоростей электронов и дырок. 8, 1366
- Добровольский В. Н., Романов А. В. Ударная ионизация и лавинный пробой в  $p-n$ -переходах, находящихся в неоднородном температурном поле. 8, 1361
- Долманов И. Н., Марков А. К., Толстихин В. И. Интерференционные эффекты в спектрах структур с квантовыми ямами. 11, 1899
- Дорин В. А., см. Дмитриев А. Г. 2, 397
- Доценко Ю. П., см. Бабич В. М. 3, 447
- Дричко И. Л., см. Аронзон Б. А. 8, 1446
- Дрозд И. А., см. Горшкова О. В. 3, 510
- Дубро В. В., см. Голикова О. А. 1, 66
- Дубров И. Н., см. Кириллова С. И. 8, 1399
- Дубровский Ю. В., Ларкин И. А., Морозов С. В. «Энергетическая квазибаллистика» в микроструктурах с двумерным электронным газом. 3, 522
- Дьяконова Н. В., см. Гусинский Г. М. 3, 543
- Евстропов В. В., Линьков И. Ю., Морозенко Я. В., Пикус Ф. Г. Фотолюминесценция компенсированного SiC-6H. 6, 969
- Евтухов Ю. Н., см. Бабенцов В. Н. 6, 1063
- Егоров А. Ю., см. Алфёров Ж. И. 10, 1715
- Екимов А. И., см. Гуревич С. А. 1, 102
- Емцев В. В., см. Голубев В. Г. 3, 574
- Емцев В. В., Машовец Т. В., Михнович В. В. Пары Френкеля в германии и кремнии (обзор). 1, 22
- Еремин В. К., см. Вербицкая Е. М. 11, 1962
- Еремин В. К., Иванов А. М., Строган Н. Б. Ложные пики в спектрах DLTS планарных диодных структур. 3, 477
- Ершов О. Г., см. Баранов А. Н. 11, 1971
- Жадько И. П., см. Бабичев Г. Г. 7, 1244
- Жадько И. П., см. Бабичев Г. Г. 10, 1723
- Жадько И. П., см. Буянов А. В. 4, 629
- Жадько И. П., см. Гасан-заде С. Г. 6, 1100
- Жалко-Титаренко И. В., Крайчинский А. Н., Рогоцкий И. С. Непереориентируемая дивакансия в кремнии. 1, 180
- Ждан А. Г., см. Веденеев А. С. 6, 1096
- Ждан А. Г., см. Веденеев А. С. 12, 2017
- Ждан А. Г., см. Гольдман Е. И. 12, 2048
- Ждан А. Г., Козлов А. М., Костинская Т. А., Кочеров В. Ф., Рыльков В. В. Динамические вольт-амперные характеристики фоточувствительных слоистых структур на основе сильно легированного Si (As) с блокированной проводимостью по примесной зоне. 12, 2024
- Жегалин В. А., см. Акчурин Р. Х. 8, 1409
- Жерздев А. Б., Карпов В. Г., Певцов А. В., Пилятов А. Г., Феофанов Н. А. Электролюминесценция в  $p-n$ -структурах на основе  $n-Si_{1-x}C_x$ : H. 4, 750
- Житинская М. К., см. Березин А. В. 8, 1405
- Житинская М. К., см. Немов С. А. 8, 1493
- Жуков А. Е., см. Алфёров Ж. И. 10, 1715
- Жуковский П. В. Влияние условий ионной имплантации на дефектообразование в кремнии. 1, 150
- Забродский А. Г., Андреев А. Г., Алексеев М. В. Прыжковая проводимость  $K = 0.3$ -серии образцов Ge:Ga эффект насыщения, перескоки по ближайшим соседям и переход к прыжкам с переменной длиной. 3, 431
- Завьялов В. В., Раданцев В. Ф., Дерябина Т. И. Особенности туннелирования в барьерах Шоттки на основе узкощелевого полупроводника  $p-Hg_{1-x}Cd_xTe$ . 4, 691
- Заднипру И. Б., см. Сырбу Н. Н. 2, 232
- Заднипру И. Б., см. Сырбу Н. Н. 7, 1225
- Зайнабидинов С. З., см. Абдураимов А. 10, 1845
- Закиров А. С., Игамбердыев Х. Т., Мамадалимов А. Т., Хабибуллаев П. К. Лазерно-стимулированная диффузия золота в кремнии. 7, 1282
- Залетаев Н. Б., см. Винокуров Л. А. 4, 770
- Зарицкий Г. В., см. Водаков Ю. А. 1, 107
- Засавицкий Е. А., см. Бойко М. П. 3, 568
- Засавицкий И. И., Матвеев А. В., Мацинашвили Б. Н., Трофимов В. Т. Кинетика и спектр фотопроводимости гетероструктур  $PbTe/Pb_{1-x}Sn_xTe$ , выращенных на подложках  $BaF_2$ . 12, 2031
- Захаренков Л. Ф., см. Козловский В. В. 1, 3
- Захарикова Л. П., см. Абрамов А. А. 3, 500
- Захарова А. А., Рыжий В. И. Эффекты туннелирования квазичастиц в структурах на основе гетеропереходов второго типа. 7, 1182
- Захарова И. Б., см. Бакуева Л. Г. 11, 2011
- Звонарева Т. К., см. Азерьянов В. Л. 5, 918
- Звонков Б. Н., см. Алешкин В. Я. 3, 516
- Звонков Б. Н., см. Алешкин В. Я. 10, 1848
- Звонков Б. Н., см. Карпович И. А. 11, 1886
- Зебрев Г. И. Вольт-амперная характеристика МОП транзистора с учетом зависимости подвижности от продольного электрического поля. 1, 83
- Зебрев Г. И. Статическое экранирование в инверсионном слое. 9, 1550
- Зерга Г., см. Айдаралиев М. Ш. 2, 246
- Земский В. И., см. Бегер В. Н. 5, 911
- Земсков Б. Г., см. Алексеева Г. Т. 2, 358
- Зикриллаев Н. Ф., см. Бахадырханов М. К. 9, 1536
- Зинченко Э. А., см. Буянов А. В. 4, 629
- Зинченко Э. А., см. Гасан-заде С. Г. 6, 1100
- Зинчик Ю. С., см. Вуль А. Я. 1, 111
- Зинчик Ю. С., см. Вуль А. Я. 1, 146
- Зинчик Ю. С., см. Вуль А. Я. 2, 295
- Зотов В. В., см. Бурлак А. В. 3, 548
- Затов К. И., см. Бабич В. М. 3, 447
- Зотова Н. В., см. Айдаралиев М. Ш. 2, 246
- Зотова Н. В., см. Гусев О. Б. 4, 738
- Зудеев О. Г., см. Амиров Р. Х. 4, 592



- Зуев В., В. Клышевич А. И., Стяпо-  
навичюс А. А., Яковлев М. П. Темпера-  
турная зависимость времени релаксации  
фотопроводимости  $n\text{-Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$  в микро-  
волновом поле. 1, 171
- Зыков Н. В. Флукуационные пограничные  
состояния в гетеропереходе. 9, 1645
- Зыков Г. А., см. Лашкарев Г. В. 10, 1825
- Иванов А. М., см. Вербицкая Е. М., 11, 1962
- Иванов А. М., см. Еремин В. К. 3, 477
- Иванов С. В., см. Алфёров Ж. И. 10, 1715
- Иванов-Омский В. И., см. Андрухив А. М.  
7, 1288
- Иванов-Омский В. И., см. Георгиц Э. И.  
1, 89
- Иванов-Омский В. И., Кутехов Н. В.,  
Смирнов В. А., Юлдашев Ш. У., Га-  
даев О. А. Нейтронное облучение  
 $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$ . 3, 420
- Иванов-Омский В. И., Петров И. А.,  
Смирнов В. А., Ястребов С. Г. Магнито-  
фотолуминесценция узкощелевого полупро-  
водника  $\text{Hg}_{0.77}\text{Cd}_{0.23}\text{Te}$ . 2, 305
- Иванов-Омский В. И., Смирнов В. А.,  
Юлдашев Ш. У., Гадаев О. А.,  
Стрэдлинг Р. А., Фергусон И. Фо-  
толюминесценция эпитаксиального слоя  $\text{InSb}$   
на квазиполуизолирующей подложке  $p\text{-InSb}$ .  
3, 413
- Иванов-Омский В. И., Харченко В. А.,  
Цыпишка Д. И. Спектр мелкого акцептора  
в полумажнитном полупроводнике в  
магнитном поле. 10, 1728
- Иванченко И. В., см. Вертий А. А. 4, 585
- Иванчик И. И., см. Белононь С. А. 2, 264
- Иванчик И. И., см. Де Виссер А. 6, 1034
- Ивашова Т. А., см. Кадушкин В. И. 2, 384
- Ивченко Е. Л., Киселев А. А. Электронный  
 $g$ -фактор в квантовых ямах и сверхрешетках.  
8, 1471
- Игамбердыев Х. Т., см. Закиров А. С. 7,  
1282
- Игнатов А. В., см. Бурлак А. В. 3, 548
- Игнатьев А. С., Каминский В. Э., Ко-  
пылов В. Б., Мокеров В. Г., Немцев  
Г. З., Шмелев С. С., Шубин В. С.  
Влияние спейсер-слоев на вольт-амперную  
характеристику туннельно-резонансных  
диодов. 10, 1795
- Идлис Б. Г., Усманов М. М. Пограничные  
состояния в ограниченных полупроводнико-  
вых структурах с инвертированными зонами.  
2, 329
- Идлис Б. Г., Фролов В. Д. К вопросу о  
шумах в полупроводниковых структурах с  
инжекционной неустойчивостью. 1, 187
- Иззатов Б. М., см. Асламов Г. К. 4, 703
- Икраимов Р. Г., см. Голикова О. А. 1, 66
- Икраимов Р. Г., см. Голикова О. А. 1, 71
- Ильин В. И., см. Бакуева Л. Г. 11, 2011
- Ильин В. Ю., см. Акимов Б. А. 7, 1300
- Ильин Н. П., Васильев А. Э., Мастеров  
В. Ф. Основное состояние переходных эле-  
ментов группы железа в арсениде и фосфиде  
галлия. 11, 1878
- Ильин Н. П., Мастеров В. Ф., Васильев  
А. Э. Примесный центр с частично запол-  
ненной  $d$ -оболочкой в бинарном полупро-  
воднике. 11, 1866
- Ильинский А. В., Куценко А. Б., Сте-  
панова М. Н. Экранирование поля в  $p$ -  
 $i$ - $n$ -структурах на основе арсенида галлия  
при приложении напряжения обедняющей  
полярности. 4, 710
- Ильичев Э. А., см. Гергель В. А. 5, 794
- Илющенко И. Ю., см. Гуга К. Ю. 12, 2146
- Именков А. Н., см. Баранов А. Н. 11, 1971
- Исмаилов А. А., Гасымов Ш. Г., Маме-  
дов Т. С., Аллахвердиев К. Р. Влияние  
давления на электропроводность и эффект  
Холла селенида индия. 11, 1995
- Истратов А. А., см. Вывенко О. Ф. 10, 1693
- Йодказис С., Пятраускас М.,  
Нятикшис В., Утенко В. Исследование  
рекомбинационных процессов неравновес-  
ных носителей заряда в эпитаксиальных  
слоях арсенида галлия. 8, 1394
- Кабанов В. Ф. Исследование фотоэ-  
лектрических свойств пленок магнитного  
полупроводника  $\text{Eu}_{1-x}\text{Sm}_x\text{O}$ . 10, 1837
- Кадушкин В. И. Стимулированные  
магнитным полем осцилляции стационарной  
ЭДС в системе вырожденных  $2D$ - $3D$ -элек-  
тронов. 5, 806
- Кадушкин В. И. Затухание квантования Лан-  
дау как метод идентификации механизмов  
релаксации  $2D$ -электронов. 7, 1323
- Кадушкин В. И., Ивашова Т. А. Высоко-  
чувствительный датчик Холла на основе се-  
лективно-легированной гетеросистемы с  $2D$ -  
электронами как четырехполосника. 2, 384
- Кадушкин В. И., Фомичев С. И. Элек-  
тронная  $2D$ - $3D$ -система—квантовый диод.  
1. Общие свойства. 5, 811
- Кадыров Д. И., Минаев В. С., Фран-  
кевич Е. Л. Магнитные спиновые эффекты  
на фотопроводимости аморфного  $\text{As}_2\text{Se}_3$ . 2,  
373
- Кадышев С. К., см. Громовой Ю. С. 4, 778
- Кадышев С. К., см. Громовой Ю. С. 12, 2098
- Кадышев С. К., см. Ройцин А. Б. 12, 2091
- Казакевич Л. А., Лугаков П. Ф. Особен-  
ности отжига компенсирующих ра-  
диационных дефектов в бездислокационном  
 $n$ -кремнии. 6, 1142
- Казанин М. М., см. Голикова О. А. 1, 66
- Казанин М. М., см. Голикова О. А. 1, 71
- Казанцев А. Б., Ларионов В. Р., Румян-  
цев В. Д., Танклевская Е. М.,  
Хвостиков В. П. Полосковые зародившие  
 $\text{AlGaAs}$ -гетеролазеры, полученные методом  
жидкофазной эпитаксии в одностадийном  
процессе. 9, 1666
- Кайданов В. И., Немов С. А., Равич Ю.  
И. Резонансное рассеяние носителей тока в  
полупроводниках типа  $A^{\text{IV}}B^{\text{VI}}$  (обзор). 2,  
201
- Каленик В. И., см. Гасан-заде С. Г. 6, 1100
- Калинкин И. П., см. Беляев А. П. 10, 1755
- Кальфа А. А., Крюков А. Р., Тагер А. С.  
Управление вольт-амперными харак-

- теристиками трех связанных резонансно-туннельных диодов. 5, 896
- Кальфа А. А., Пашковский А. Б., Тагер А. С. Полевая и ударная ионизация глубоких энергетических уровней в полевых транзисторах на гетероструктурах с селективным легированием. 9, 1574
- Кальфа А. А., Чикун В. В. Вольт-амперные характеристики диодов Шоттки со слоем слабо легированного полупроводника в области пространственного заряда. 6, 1024
- Каменец А. В., см. Александров О. В. 5, 868
- Камерцель А. Ю., см. Сырбу Н. Н. 4, 669
- Камерцель А. Ю., см. Сырбу Н. Н. 7, 1191
- Каминский В. Э., см. Игнатъев А. С. 10, 1795
- Канцер В. Г., Леляков И. А., Малкова Н. М. Эффект инверсии зон приграничных электронных состояний в сверхрешетках на базе полупроводников  $A^{\text{III}}B^{\text{V}}$ . 9, 1596
- Капустин Ю. А., см. Белявский В. И. 10, 1832
- Караваяев Г. Ф., см. Даварашвили О. И. 5, 906
- Карандашев С. А., Айдаралиев М. Ш. 2, 246
- Карачевцева Л. А., см. Бакши И. С. 1, 173
- Карачевцева Л. А., Любченко А. В. К вопросу о собственной концентрации носителей заряда в твердых растворах  $Cd_xHg_{1-x}Te$ . 7, 1342
- Карачевцева Л. А., Любченко А. В., Маловичко Э. А. Особенности магнитополевых зависимостей кинетических коэффициентов в двухслойных структурах  $Cd_xHg_{1-x}Te$ . 3, 535
- Кардо-Сысоев А. Ф., Попова М. В., Шеметило Д. И. Влияние накопления неосновных носителей в  $p^+$ -слое на процесс восстановления напряжения на  $p^+ - n$ -переходе. 6, 1048
- Карзанов В. В., см. Демидов Е. С. 9, 1656
- Карзанов В. В., см. Лобанов Н. Е. 8, 1514
- Карзанов В. В., см. Павлов П. В. 6, 1148
- Карпов В. Г., см. Жерадев А. Б. 4, 750
- Карпович И. А., см. Алешкин В. Я. 10, 1848
- Карпович И. А., Алешкин В. Я., Аншон А. В., Байдусь Н. В., Батукова Л. М., Звонков Б. Н., Планкина С. М. Фотоэлектронные явления в слоях GaAs с встроенной на поверхности квантовой гетероямой. 11, 1886
- Карпович И. А., см. Бедный Б. И. 8, 1383
- Карпович И. А., см. Бедный Б. И. 11, 1984
- Карпович И. А., Планкина С. М. Фотоэлектрический метод определения коэффициента оптического поглощения и его применение к полуизолирующему GaAs. 7, 1313
- Карумидзе Г. С., Джобова Д. Ш., Тевзаде Г. А., Шавелашвили Ш. Ш. Некоторые аспекты применения кремния, легированного изотопом бор-11. 12, 2138
- Карфул Р., см. Дмитриев А. Г. 2, 397
- Карягин В. В., см. Ляпилин И. И. 1, 122
- Карягин С. Н., Константинова Е. А. Применение метода насыщения сигналов электронного парамагнитного резонанса для исследования кремния аморфного гидрированного карбида\* кремния переменного состава. 12, 2129
- Касиян В. А., см. Блажку А. И. 5, 900
- Касиян В. А., см. Джуади Д. 8, 1433
- Катаев С. Г., см. Даварашвили О. И. 5, 906
- Катана П. К. Многофотонное межзонное поглощение лазерного излучения в полупроводниках с участием примесных уровней. 3, 578
- Качурин Г. А., Гадиак Г. В., Шатров В. И., Тысченко И. Е. Восходящая диффузия примеси при ионном облучении нагретого кремния: численное моделирование. 11, 1978
- Качурин Г. А., Тысченко И. Е., Плотноков А. Е., Попов В. П. Рост монокристаллического  $\alpha\text{-Si}_3\text{N}_4$  в захороненных слоях, полученных низкоинверсионной имплантацией ионов  $N^+$  в нагретый кремний. 8, 1390
- Кашерининов П. Г., Резников Б. И., Царенков Г. В. Фотоэффект в структуре металл-полупроводник-металл на основе высокоомного полупроводника. 8, 1480
- Кашкоров П. К., Русина М. В., Тимошенко В. Ю. Модификация коэффициента отражения полупроводников  $A^{\text{III}}B^{\text{V}}$  при импульсном лазерном облучении. 10, 1835
- Кашкоров П. К., Тимошенко В. Ю. Модификация спектра мелких состояний арсенида галлия под действием импульсного лазерного излучения. 7, 1321
- Квон З. Д., см. Буданцев М. В. 9, 1565
- Квон З. Д., см. Гусев Г. М. 3, 539
- Киреенко В. П., см. Гусев О. К. 6, 1138
- Кириллова С. И., Моин М. Д., Примаченко В. Е., Свечников С. В., Чернойбай В. А., Дубров И. Н. Изменение электронных свойств системы Si-SiO<sub>2</sub> при лазерном облучении. 8, 1399
- Киркинский В. А., см. Куреева Р. Г. 4, 730
- Киселев А. А., см. Ивченко Е. Л. 8, 1471
- Кисин М. В. Спиновая структура пограничных состояний и циркулярный фотогальванический эффект в гетеропереходах. 5, 785
- Китык И. В., см. Крочук А. С. 6, 1028
- Кладько В. П., Крыштаб Т. Г., Клейнфельд Ю. С., Семенова Г. Н., Хазан Л. С. Влияние утоньшения подложки на оптические свойства эпитаксиальных слоев арсенида галлия (эффект дальнего действия). 2, 368
- Кладько В. П., Крыштаб Т. Г., Свительский А. В., Семенова Г. Н. Эффект дальнего действия в монокристаллах GaAs с различной плотностью дислокаций. 11, 1932
- Клейнфельд Ю. С., см. Кладько В. П. 2, 368
- Клецкий С. В. Спектральные характеристики варизонных структур с нелинейным профилем состава. 9, 1631
- Климов А. А., см. Ройцин А. Б. 12, 2091
- Клингер П. М., Голубев В. Г. 3, 574
- Клышевич А. И., см. Зуев 1, 171
- Клячкин Л. Е., см. Амальская Р. М. 6, 1004
- Ковалевская Г. Г., см. Мередов М. М. 9, 1590

- Ковалевская Г. Г., Мередов М. М., Руссу Е. В., Салихов Х. М., Слободчиков С. В., Фетисова В. М. Электрические и фотозлектрические свойства диодных структур  $Pd-p-p^+-InP$  и изменение их в атмосфере водорода. 10, 1750
- Коваленко А. В., Мекекечко А. Ю., Бондарь Н. В., Тищенко В. В., Щекочихин Ю. М., Румянцева С. М., Малашенко И. С. Исследование оптических характеристик эпитаксиальных слоев  $ZnSe/GaAs(100)$ , выращенных методами молекулярно-лучевой эпитаксии и газофазной эпитаксии. 7, 1251
- Коваленко В. Ф., см. Городниченко О. К. 4, 759
- Коваленко Н. В., см. Гусев Г. М. 3, 539
- Коварский В. А., Чеботарь В. Н. Электрон-фононный механизм уширения оптических полос поглощения в квазиульмерных кристаллах. 10, 1828
- Ковальчук В. Б., см. Бабич В. М. 3, 447
- Ковалюк З. Д., см. Козьмик И. Д. 11, 1993
- Козлов А. М., см. Ждан А. Г. 12, 2024
- Козлов В. А., см. Берман Л. С. 8, 1507
- Козлов Е. Б., см. Андреев Б. А. 5, 927
- Козловский В. В., Захаренков Л. Ф., Шустров Б. А. Трансмутационное легирование полупроводников под действием заряженных частиц (обзор). 1, 3
- Козловский С. И., см. Бабичев Г. Г. 7, 1244
- Козловский С. И., см. Бабичев Г. Г. 10, 1723
- Козуб В. И. Новые книги по полупроводникам. 1, 192; 7, 1355; 9, 1675
- Козьмик И. Д., Нетяга В. В., Бахматюк Б. П., Григорчак И. И., Ковалюк З. Д. Некоторые закономерности и новые возможности интеркалированных халькогенидных полупроводников. 11, 1993
- Кокин В. А., см. Котельников И. Н. 8, 1462
- Колесник С. П., см. Лашкарев Г. В. 10, 1768
- Колынько Н. И., см. Крочук А. С. 6, 1028
- Колковский И. И., Латышенко В. Ф., Лугаков П. Ф., Шуша В. В. Рекомбинация носителей заряда в термообработанном Si с различными типами ростовых микродефектов. 1, 176
- Коллюх А. Г., Мороженко В. А. Влияние магнитного поля на поляризацию теплового излучения изотропных полупроводников. 12, 2107
- Колыгина В. М., см. Воронков В. П. 6, 1120
- Комаров Б. А. Влияние условий эксперимента на результаты обработки DLTS-спектров методом анализа формы линии. 9, 1625
- Комаров Ф. Ф., см. Новиков А. П. 10, 1841
- Кондратьева О. Г., см. Бегучев В. П. 7, 1236
- Константинов А. О. О природе точечных дефектов, генерируемых при диффузии акцепторных примесей в карбиде кремния. 2, 270
- Константинов А. О. О причине возникновения приповерхностного плато диффузионного профиля фосфора в кремнии. 2, 339
- Константинов А. О., см. Водаков Ю. А. 11, 1857
- Константинов О. В., см. Бычковский Д. Н. 4, 653
- Константинов О. В., см. Бычковский Д. Н. 5, 921
- Константинов О. В., см. Бычковский Д. Н. 12, 2118
- Константинов П. П., см. Алексеева Г. Т. 2, 358
- Константинова Е. А., см. Карягин С. Н. 12, 2129
- Константинова Н. Н., Магомедов М. А., Рудь В. Ю., Рудь Ю. В. Оптические гетероконтакты на основе пленок  $CuInSe_2$ . 3, 558
- Константинова Н. Н., Магомедов М. А., Рудь В. Ю., Рудь Ю. В. Поляризационная фоточувствительность тонкопленочных структур  $p-CuInSe_2-n-CdS$ . 11, 1861
- Копылов В. Б., см. Игнатъев А. С. 10, 1795
- Копьев П. С., см. Алфёров Ж. И. 10, 1715
- Корбутяк Д. В., см. Бобицкий Я. В. 10, 1688
- Коровина Л. А., см. Дарчук С. Д. 5, 845
- Королева О. С., Чулков Е. В. Самосоглавованная релятивистская электронная структура соединений  $A^{III}B^V$ . 2, 223
- Корольков В. И., см. Аврутин Е. А. 4, 719
- Коропчану В. П., см. Гифейсман Ш. Н. 5, 949
- Короткевич А. В., Никитин В. А., Эйдельман Б. Л. Кинетика СВЧ фотопроводимости в подложках Si с внутренним гетеродом и бездефектной зоной. 5, 942
- Корсунская Н. Е., см. Байдуллаева А. 5, 801
- Корсунская Н. Е., см. Крюкова И. В. 6, 1054
- Костин А. А., см. Алешкин В. Я. 2, 318
- Костинская Т. А., см. Ждан А. Г. 12, 2024
- Костылев С. А., см. Горев Н. Б. 5, 861
- Котельников И. Н., Кокин В. А., Медведев Б. К., Мокеров В. Г., Ржанов Ю. А., Анохина С. П. Характеристика и особенности проводимости приповерхностных  $\delta$ -легированных слоев в GaAs при изменении концентрации двумерных электронов. 8, 1462
- Кочеров В. Ф., см. Винокуров Л. А. 4, 770
- Кочеров В. Ф., см. Ждан А. Г. 12, 2024
- Кочнев И. В., см. Соболев М. М. 10, 1760
- Коршунов Ф. П., Маркевич В. П., Медведева И. Ф., Мурин Л. И. Об акцепторных уровнях дивакансии в кремнии. 11, 2007
- Крайчинский А. Н., см. Жалко-Титаренко И. В. 1, 180
- Краснобаев Л. Я., см. Омеляновская Н. М. 6, 1116
- Краснов А. Н., Ваксман Ю. Ф., Пуртов Ю. Н. Электрические свойства монокристаллов  $p-ZnSe$ . 11, 2001
- Краснов А. Н., Ваксман Ю. Ф., Пуртов Ю. Н., Сердюк В. В. Получение дырочной проводимости в монокристаллах цинка. 6, 1151
- Крещук А. М., Новиков С. В., Савельев И. Г. Низкотемпературная подвижность

- 2МЭГ и качество гетерограницы в гетероструктурах InGaAs/InP, выращенных жидкофазной эпитаксией. 8, 1375
- Кропотов Г. И., см. Голубев В. Г. 3, 574
- Крочук А. С., Китык И. В., Колынько Н. И. Электронная структура слоистых полупроводниковых кристаллов иодида теллура. 6, 1028
- Крылов Д. Г., Ладыгин Е. А., Галеев А. П. Модель радиационного накопления дефектов в системе кремний—оксид кремния. 7, 1347
- Крыштаб Т. Г., см. Кладыко В. П. 2, 368
- Крыштаб Т. Г., см. Кладыко В. П. 11, 1932
- Крюков А. Р., см. Кальфа А. А. 5, 896
- Крюков С. В., см. Вязовский М. В. 1, 184
- Крюкова И. В., Теплицкий В. А., Шульга Е. П., Джумаев Б. Р., Корсунская Н. Е. Влияние избыточного давления паров компонентов на ансамбль точечных дефектов в кристаллах CdS. 6, 1054
- Крючков С. В., Сыродоев Г. А. Влияние процессов ионизации примесей на проводимость сверхрешетки в немонокристаллическом поле. 4, 774
- Кудрявцев И. А., см. Гуревич С. А. 1, 102
- Кудрявцев Ю. А., Новиков Е. Б., Стусь Н. М., Чайкина Е. И. Сульфидная пассивация поверхности арсенида индия. 10, 1742
- Кузьма М. С., см. Вирт И. С. 3, 562
- Кулеев И. Г., см. Ляпилин И. И. 1, 122
- Кулиев Б. И., см. Аскеров Б. М. 4, 755
- Кульбачинский В. А., см. Абрамов В. В. 5, 878
- Кульбачинский В. А., Кытин В. Г., Абрамов В. В., Тимофеев А. Б., Ульяшин А. Г., Шлопак Н. В. Прыжковая проводимость ионно-имплантированного серой кремния. 10, 1801
- Кунцевич Т. С., см. Аleshкин В. Я. 3, 516
- Куряева Р. Г., Киркинский В. А. Спектры комбинационного рассеяния и фазовые переходы в AgAsS<sub>2</sub> под давлением. 4, 730
- Кустов В. Е., Ройцин А. Б., Трипаченко Н. А., Шаховцов В. И. Центры дилатации в облученном электронами кремнии. 11, 1928
- Кутехов Н. В., см. Иванов-Омский В. И. 3, 420
- Кущенко А. Б., см. Ильинский А. В. 4, 710
- Кытин В. Г., см. Абрамов В. В. 5, 878
- Кытин В. Г., см. Кульбачинский В. А. 10, 1801
- Кязым-заде А. Г. О связи между порогами протекания в теории протекания. 1, 169
- Кязымзаде Р. З., см. Аджаров Г. Х. 3, 553
- Лагунова Т. С., см. Баранов А. Н. 9, 1612
- Ладыгин Е. А., см. Крылов Д. Г. 7, 1347
- Ларионов В. Р., см. Казанцев А. Б. 9, 1666
- Ларионова В. А., см. Германенко А. В. 12, 2136
- Ларкин И. А., см. Дубровский Ю. В. 3, 522
- Латышенко В. Ф., см. Колковский И. И. 1, 176
- Лашкарев Г. В., Бродовой А. В., Мирец А. Л., Зыков Г. А. Электронное состояние примеси индия в узкощелевых полупроводниках Pb<sub>0.82</sub>Sn<sub>0.18</sub>Te, Cd<sub>0.2</sub>Hg<sub>0.8</sub>Te. 10, 1825
- Лашкарев Г. В., Бродовой А. В., Радченко М. В., Мирец А. Л., Паренская Е. С., Никитин М. С., Растегин Ю. И., Колесник С. П. Электрические, термоэлектрические и магнитные свойства Cd<sub>0.2</sub>Hg<sub>0.8</sub>Te, легированного индием. 10, 1768
- Левинштейн М. Е. Первый международный симпозиум по исследованию перспективных полупроводниковых приборов (ISDRS-91). 6, 1153
- Левинштейн М. Е., см. Гусинский Г. М. 3, 543
- Леденцов Н. Н., см. Алфёров Ж. И. 10, 1715
- Леляков И. А., см. Канцер В. Г. 9, 1596
- Леринман Н. К., см. Цидильковский И. М. 11, 1894
- Лигачев В. А., Филиков В. А. О природе эффекта псевдолегирования в  $\alpha$ -Si:H. 9, 1540
- Линьков И. Ю., см. Евстропов В. В. 6, 969
- Литвак А. М., см. Баранов А. Н. 9, 1612
- Литвин Д. П., см. Вереничкова Р. Г. 6, 1008
- Лифшиц Т. М., см. Андреев Б. А. 5, 927
- Лихарев С. К., см. Выборнов В. В. 12, 2076
- Лобанова Н. Е., Карзанов В. В., Тетельбаум Д. И. Об аномальной дозовой зависимости концентрации VV-центров в кремнии при ионной имплантации азота. 8, 1514
- Логвинов Г. Н. Термоздс в полупроводниковых субмикронных пленках. 3, 461
- Логвинов Г. Н. Граничные условия для функции распределения электронов в полупроводниковых субмикронных пленках в теории термоэлектричества. 6, 1104
- Логвинов Г. Н., см. Гуревич Ю. Г. 11, 1945
- Лугаков П. Ф., см. Казакевич Л. А. 6, 1142
- Лугаков П. Ф., см. Колковский И. И. 1, 176
- Лугаков П. Ф., Лукьяница В. В. Влияние предварительной термообработки на эффективность образования радиационных дефектов в бездислокационном кремнии. 8, 1509
- Лукьяница В. В., см. Лугаков П. Ф. 8, 1509
- Лукьянченко А. И., см. Гергель В. А. 5, 794
- Лупал М. В., см. Глинский Г. Ф. 4, 644
- Луценко Е. В., см. Грибковский В. П. 11, 1920
- Львин В. Э., см. Сырбу Н. Н. 2, 232
- Львов Т. В., см. Берковиц В. Л. 7, 1264
- Любин В. М., см. Аверьянов В. Л. 5, 918
- Любченко А. В., см. Бакши И. С. 1, 173
- Любченко А. В., см. Карачевцева Л. А. 3, 535
- Любченко А. В., см. Карачевцева Л. А. 7, 1342
- Любченко В. Е., см. Борисов В. И. 4, 611
- Ляпилин И. И., Кулеев И. Г., Карягин В. В. Явления переноса в квантовой яме, содержащей примеси с переменной валентностью. 1, 122
- Магомедов М. А., см. Константинова Н. Н. 3, 558

- Магомедов М. А., см. Константинова Н. Х. 11, 1861
- Магомедов М. А., Медведкин Г. А., Рудь В. Ю., Рудь Ю. В. Получение и свойства изотипных гетероструктур на основе  $n$ - $\text{CaInSe}_2$ . 3, 556
- Магомедов М. А., Прочухан В. Д., Рудь Ю. В. Фотоэлектрические свойства диодов Шоттки  $\text{In}-p\text{-CuInSe}_2$ . 11, 1997
- Макарова Т. В., см. Горев Н. Б. 5, 861
- Макарова Т. В., см. Горев Н. Б. 7, 1339
- Макарова Т. Л., см. Вуль А. Я. 1, 111
- Макарова Т. Л., см. Вуль А. Я. 1, 146
- Максименко В. М., см. Бабич В. М. 3, 447
- Малаховская В. Э., см. Бумай Ю. А. 7, 1306
- Малашенко И. С., см. Коваленко А. В. 7, 1251
- Малкина И. С., см. Алешкин В. Я. 3, 516
- Малкина И. Г., см. Алешкин В. Я. 10, 1848
- Малкова Н. М., см. Канцер В. Г. 9, 1596
- Маловичко Э. А., см. Карачевцева Л. А. 3, 535
- Мальцев С. В., Принц В. Я. Сильнополевое заполнение глубоких уровней в гетероструктурных полевых транзисторах с модулированным легированием ( $\text{AlGaAs/GaAs}$ ). 12, 2133
- Малютенко В. К., см. Владимиров В. В. 9, 1580
- Малютенко В. К., см. Гуга К. Ю. 12, 2141
- Мамадалимов А. Т., см. Закиров А. С. 7, 1282
- Маматкаримов О. О., см. Абдураимов А. 10, 1845
- Мамедов Т. С., см. Исмаилов А. А. 11, 1995
- Мананов С. М., Таурбаев Т. И. Особенности температурных зависимостей фотоэлектрических характеристик  $\alpha\text{-Si} : \text{H}$ -фотопреобразователей с зеркально отражающим тыльным контактом. 6, 1145
- Маргарян А. Л., см. Арутюнян В. М. 3, 550
- Маркевич В. П., см. Бринкевич Д. И. 4, 682
- Маркевич В. П., см. Коршунов Ф. П. 11, 2007
- Марков А. В., см. Гукасян А. М. 3, 525
- Марков А. К., см. Долманов И. Н. 11, 1899
- Мартисов М. Ю. Механизм снижения плотности дислокаций при изовалентном легировании полупроводниковых соединений  $\text{A}^{\text{III}}\text{B}^{\text{V}}$ . 5, 822
- Мастеров В. Ф., см. Георгицэ Е. И. 1, 89
- Мастеров В. Ф., см. Ильин Н. П. 11, 1866
- Мастеров В. Ф., см. Ильин Н. П. 11, 1878
- Матвеев Б. А., см. Айдаралиев М. Ш. 2, 246
- Матвеев А. В., см. Засавицкий И. И. 12, 2031
- Матханова И. П., см. Александров О. В. 5, 868
- Махний В. П., Мельник В. В., Собищанский Б. М. Оптоэлектронные свойства селенида цинка, легированного индием. 6, 1140
- Мацонашвили Б. Н., см. Засавицкий И. И. 12, 2031
- Машовец Д. В., см. Арушанов Э. К. 2, 395
- Машовец Т. В., см. Емцев В. В. 1, 22
- Медведев Б. К., см. Гроднанский И. М. 9, 1521
- Медведев Б. К., см. Котельников И. Н. 8, 1462
- Медведева И. Ф., см. Коршунов Ф. П. 11, 2007
- Медведкин Г. А., см. Магомедов М. А. 3, 556
- Мездрогина М. М., см. Голикова О. А. 1, 66
- Мездрогина М. М., см. Голикова О. А. 5, 960
- Мезенцева М. П., см. Трифонова М. М. 7, 1327
- Мейтин М. Н., см. Айвазов А. А. 9, 1585
- Мекекечко А. Ю., см. Коваленко А. В. 7, 1251
- Меликсетян В. А., см. Арутюнян В. М. 3, 550
- Мельник В. В., см. Махний В. П. 6, 1140
- Мельник Н. Н., см. Оконечников А. П. 9, 1659
- Мельцер Б. Я., см. Алфёров Ж. И. 10, 1579
- Мерцедер М. М., см. Ковалевская Г. Г. 10, 1750
- Мередов М. М., Ковалевская Г. Г., Руссу Е. В., Слободчиков С. В. Электрические и фотоэлектрические свойства гетероструктур, полученных структурным переходом  $\text{Au}-p\text{-InP} \rightarrow \text{Au}-n\text{-In}_2\text{O}_3-p\text{-InP}$ . 9, 1590
- Меркулов И. А., см. Вергелис М. В. 10, 1784
- Мехтиев Э. И., см. Абутальябов Г. И. 9, 1643
- Мечетин А. М., см. Бегучев В. П. 7, 1236
- Михуленок А. В., см. Абрамов А. А. 3, 500
- Минаев В. С., см. Кадыров Д. И. 2, 373
- Минтаиров А. М., Смекалин К. Е., Устинов В. М., Хвостиков В. П. Фотон-плазмонные волны в спектрах комбинационного рассеяния света эпитаксиальных слоев  $n\text{-Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ . 4, 614
- Миньков Г. М., см. Германенко А. В. 12, 2136
- Мир-Багиров В. В., см. Аджаров Г. Х. 3, 553
- Мирец А. Л., см. Лашкарев Г. В. 10, 1768
- Мирец А. Л., см. Лашкарев Г. В. 10, 1825
- Миронов К. Е., см. Андрухив А. М. 7, 1288
- Мирсаатов Р. М., см. Баграев Н. Т. 3, 427
- Мирсаатов Р. М., см. Баграев Н. Т. 3, 481
- Мирсаатов Р. М., см. Баграев Н. Т. 5, 836
- Михаил Григорьевич Мильвидский (к 60-летию со дня рождения). 8, 1517
- Михнович В. В., см. Емцев В. В. 1, 22
- Могильник И. Ф., см. Сорока В. И. 9, 1547
- Мозоль П. Е., см. Байдуллаев А. 5, 801
- Моин М. Д., см. Кириллова С. И. 8, 1399
- Мокеров В. Г., см. Гродненский И. М. 9, 1521
- Мокеров В. Г., см. Игнатъев А. С. 10, 1795
- Мокеров В. Г., см. Котельников И. Н. 8, 1462
- Монастырский Л. С., Соколовский Б. С. Диффузия заряженных примесей в варзонных полупроводниках. 12, 2143
- Мордкович В. Н., см. Артамонов В. В. 12, 2083
- Мороженко В. А., см. Коллюх А. Г. 12, 2107

- Морозенко Я. В., см. Евстрпов В. В. 6, 969
- Морозов С. В., см. Дубровский Ю. В. 3, 522
- Морозова В. И., см. Сырбу Н. Н. 1, 74
- Морозова Н. К., см. Грибковский В. П. 11, 1920
- Мойсечук Г. С., см. Блажку А. И. 5, 900
- Мохов Е. Н., см. Веренчикова Р. Г. 6, 1008
- Мохов Е. Н., см. Водаков Ю. А. 1, 107
- Мохов Е. Н., см. Водаков Ю. А. 11, 1857
- Мохов Е. Н., см. Петренко Т. Л. 9, 1556
- Мошегов Н. Т., см. Гусев Г. М. 3, 539
- Мошегов Н. Т., см. Шегай О. А. 11, 1987
- Мошегов Н. Т., см. Шегай О. А. 11, 1989
- Мукашев Б. Н., Тамендаров М. Ф., Токмолды С. Ж. Состояние водородо- и мезанзимы пассивации примесей и радиационных дефектов в кристаллическом кремнии. 6, 1124
- Муленков С. Ю., см. Воронков В. П. 6, 1120
- Мурин Л. И., см. Бринкевич Д. И. 4, 682
- Мурин Л. И., см. Коршунов Ф. П. 11, 2007
- Мусаев А. М., см. Гаджалиев М. М. 11, 1952
- Мусихин С. Ф., см. Бакуева Л. Г. 11, 2011
- Мухитдинов А. М., Стафеев В. И. Время жизни неосновных носителей заряда в эпитаксиальных слоях  $Cd_xHg_{1-x}Te$   $p$ -типа проводимости. 10, 1830
- Мясников А. М., см. Герасименко Н. Н. 9, 1651
- Наливкина З. А., см. Талипов Н. Х. 2, 310
- Недеогло Д. Д., см. Блажку А. И. 5, 900
- Недеогло Д. Д., см. Джуади Д. 8, 1433
- Немов С. А., см. Березин А. В. 8, 1405
- Немов С. А., см. Кайданов В. И. 2, 201
- Немов С. А., Равич Ю. И., Житинская М. К., Прошин В. И. Самокомпенсация электроактивных примесей собственными дефектами в твердых растворах  $Pb_{0.8}Sn_{0.2}Te$ . 8, 1493
- Немцев Г. З., см. Игнатъев А. С. 10, 1795
- Нетяга В. В., см. Козычик И. Д. 11, 1993
- Неустроев Л. Н., см. Бегучев В. П. 7, 1236
- Нечипорук Б. Д., см. Артамонов В. В. 4, 725
- Нечипорук Б. Д., см. Артамонов В. В. 12, 2083
- Никитенко В. Р. Теоретическая модель туннельного дисперсионного транспорта в неупорядоченных материалах. 8, 1438
- Никитин В. А., см. Короткевич А. В. 5, 942
- Никитин М. С., см. Лашкарев Г. В. 10, 1768
- Никитина Т. Д., см. Бумай Ю. А. 7, 1306
- Никорич А. В., см. Андроник К. И. 5, 839
- Никорич А. В., см. Де Виссер А. 6, 1034
- Новак В. И., см. Савицкий В. Г. 3, 571
- Новиков А. П., Гусakov В. Г. А., Комаров Ф. Ф., Толстух В. П. О механизме ионно-индуцированной кристаллизации в кремнии. 10, 1841
- Новиков Е. Б., см. Кудрявцев Ю. А. 10, 1742
- Новиков С. В., см. Крепчук А. М. 8, 1375
- Новотоцкий-Власов Ю. Ф., см. Шемелина О. С. 6, 1015
- Ноймани Х., см. Сырбу Н. Н. 2, 232
- Няткишис В., см. Йодказис С. 8, 1394
- Ободников В. И., см. Герасименко Н. Н. 9, 1651
- Оборина Е. И., см. Воронков В. П. 6, 1120
- Оконечников А. П., Мельник Н. Н. Влияние отжига на спектр глубоких центров захвата в ZnSe. 9, 1659
- Омельяновская Н. М., Краснобаев Л. Я. Влияние температуры отжига имплантированного хлором кремния на образование электрически активных комплексов. 6, 116
- Орлов Н. Ю., см. Аврутин Е. А. 4, 719
- Осаулenco О. П., см. Авруцкий И. А. 11, 1907
- Осинский А. В., см. Гуревич С. А. 1, 102
- Осипов В. Ю., см. Вуль А. Я. 1, 111
- Осипов В. Ю., см. Вуль А. Я. 1, 146
- Осипов Е. Б., см. Аверкиев Н. С. 7, 1269
- Остапов С. Э., см. Боднарук О. А. 3, 468
- Остроумов А. Г., см. Водаков Ю. А. 1, 107
- Охонин С. А., Французов А. А. О механизме образования области пространственного заряда в МОП транзисторе при температуре 4.2 К. 5, 832
- Павлов П. В., Демидов Е. С., Карзанов В. В. Эффект дальнего действия в полупроводящих полупроводниках GaAs и InP при облучении ионами аргона. 6, 1148
- Палкин А. М., см. Шегай О. А. 11, 1987
- Палкин А. М., см. Шегай О. А. 11, 1989
- Панахов М. М., см. Аскеров Б. М. 4, 755
- Панахов М. М., см. Бычковский Д. Н. 4, 653
- Панов В. П., Панова Г. Д. Неустойчивость проводимости, вызванная электрическим нарушением электронно-молекулярного равновесия в приповерхностном слое пленок CdS. 7, 1351
- Панов В. П., Панова Г. Д., Шейнкман М. К. Долговременные релаксации проводимости, обусловленные фотостимулированной диффузией кислорода до межзеренным границам в пленках сульфида кадмия. 1, 95
- Панова Г. Д., см. Панов В. П. 1, 95
- Панова Г. Д., см. Панов В. П. 7, 1351
- Папазян К. З., см. Абрамян Ю. А. 2, 257
- Папенцев М. И., см. Соболев М. М. 10, 1760
- Паранчич С. Ю., см. Цидильковский И. М. 11, 1894
- Паранчич Ю. С., см. Цидильковский И. М. 11, 1894.
- Паренская Е. С., см. Лашкарев Г. В. 10, 1768
- Парфенова И. И., см. Глинский Г. Ф. 4, 644
- Пасечник Ф. И., см. Сырбу Н. Н. 10, 1701
- Пашковский А. Б., см. Кальфа А. А. 9, 1574
- Певцов А. Б., см. Жерзев А. Б. 4, 750
- Перель В. И., Портной М. Е. Влияние магнитного поля на линейную поляризацию фотолюминесценции в гонящих электронах в квантовых ямах. 12, 2112
- Переделкин А. Д., см. Яфасов А. М. 4, 636
- Петренко Т. Л., Тесленко В. В., Мохов Е. Н. ДЭЯР и электронная структура примесных центров бора в  $6H-SiC$ . 9, 1556

- Петров В. В., см. Алимов О. М. 11, 1914  
 Петров В. В., см. Бринкевич Д. И. 4, 682  
 Петров И. А., см. Иванов-Омский В. И. 2, 305  
 Петросян С. Г., Шик А. Я. Эффекты экранировки при образовании квазидвумерных электронных каналов. 4, 763  
 Петряков В. А., см. Бакши И. С. 1, 173  
 Пикус Ф. Г. Экситоны в квантовых ямах с двумерным электронным газом. 1, 45  
 Пикус Ф. Г., Голант Г. В. Температурная зависимость подвижности двумерного электронного газа, ограниченной примесным рассеянием, в гетероструктурах с широким спейсерным слоем. 1, 59  
 Пикус Ф. Г., см. Евстропов В. В. 6, 969  
 Пилатов А. Г., см. Жерздев А. Б. 4, 750  
 Питанов В. С., см. Аблязов А. Н. А., 6, 1041  
 Пихтин А. Н., см. Глинский Г. Ф. 4, 644  
 Пищалко В. Д., Толстихин В. И. «Эффекты фононного узкого горла» при разогреве носителей заряда в полупроводниковых микроструктурах. 4, 602  
 Планкина С. М., см. Карпович И. А. 7, 1313  
 Планкина С. М., см. Карпович И. А. 11, 1886  
 Плотников А. Е., см. Качурин Г. А. 8, 1390  
 Плотников Г. Л., см. Болотов В. В. 7, 1295  
 Плотниченко В. Г., см. Авруцкий И. А. 11, 1907  
 Пляцко С. В., см. Громовой Ю. С. 4, 778  
 Пляцко С. В., см. Громовой Ю. С. 12, 2098  
 Пляцко С. В., см. Ройцин А. Б. 12, 2091  
 Погарский М. А., см. Дмитриев А. Г. 2, 397  
 Погосов А. Г., см. Буданцев М. В. 9, 1565  
 Половцев И. С., см. Баграев Н. Т. 3, 427  
 Половцев И. С., см. Баграев Н. Т. 3, 481  
 Половцев И. С., см. Баграев Н. Т. 5, 836  
 Полторацкий Э. А., см. Гергель В. В. 5, 794  
 Попенко Н. А., см. Вертий А. А. 4, 585  
 Попов В. П., см. Качурин Г. А. 8, 1390  
 Попов В. П., см. Талипов Н. Х. 2, 310  
 Попов М. В., см. Кардо-Сысоев А. Ф. 6, 1048  
 Портной М. Е., см. Перель В. И. 12, 2112  
 Поляков М. Е., см. Трусова И. А. 6, 979  
 Полянская Т. А., см. Бильгильдеева Т. Ю. 6, 1109  
 Прима Н. А. Упругое рассеяние в многодолинных полупроводниках и его роль в релаксации энергии неравновесных электронов. 3, 530  
 Примаченко В. Е., см. Кириллова С. И. 8, 1399  
 Прицц В. Я., см. Мальцев С. В. 12, 2133  
 Прокопьев Е. П. Позитроний в полупроводниковых структурах с квантовыми ямами. 10, 1681  
 Прокофьев А. Ю., см. Венгер Е. Ф. 2, 352  
 Прокофьева Л. В., см. Алексева Г. Т. 2, 358  
 Прохоров Е. Ф., см. Горев Н. Б. 5, 861  
 Прохоров Е. Ф., см. Горев Н. Б. 7, 1339  
 Прохорович А. В., см. Городниченко О. К. 4, 759  
 Прочухан В. Д., см. Магомедов М. А. 11, 1997  
 Прошин В. И., см. Немов С. А. 8, 1493  
 Пуртов Ю. Н., см. Краснов А. Н. 6, 1151  
 Пуртов Ю. Н., см. Краснов А. Н. 11, 2001  
 Пустыльник О. Д., см. Вертий А. А. 4, 585  
 Пырково Ю. Н., см. Авруцкий И. А. 11, 1907  
 Пышная Н. Ю., Радауцан С. И., Чалдышев В. В., Чумак В. А., Шмарцев Ю. В. Изовалентное легирование фосфида индия галлием и мышьяком в процессе жидкофазной эпитаксии. 10, 1737  
 Пятраускас М., см. Йодказис С. 8, 1394  
 Равич Ю. И., см. Кайданов В. И. 2, 201  
 Равич Ю. И., см. Немов С. А. 8, 1493  
 Рагимова Н. А., см. Абуталыбов Г. И. 9, 1643  
 Раданцев В. Ф., см. Завьялов В. В. 4, 691  
 Радауцан С. И., см. Пышная Н. Б. 10, 1737  
 Радченко М. В., см. Лашкарев Г. В. 10, 1768  
 Раренко И. М., см. Боднарук О. А. 3, 468  
 Раренко И. М., см. Вертий А. А. 4, 585  
 Раренко И. М., см. Гасан-заде С. Г. 6, 1100  
 Растегин Ю. И., см. Лашкарев Г. В. 10, 1768  
 Рашковецкий Л. В., см. Бабенцов В. Н. 6, 1088  
 Резников Б. И., см. Абакумов В. Н. 2, 284  
 Резников Б. И., см. Кашерининов П. Г. 8, 1480  
 Ременюк А. Д., см. Берман Л. С. 8, 1507  
 Ремесник В. Г., см. Талипов Н. Х. 2, 310  
 Рехвишвили Д. Н., см. Борисов В. И. 4, 611  
 Решиков М. А., см. Аверкиев Н. С. 7, 1269  
 Ржанов Ю. А., см. Котельников И. Н. 8, 1462  
 Риеде В., см. Сырбу Н. Н. 2, 232  
 Рогашков А. С., см. Борисов В. И. 4, 611  
 Рогоцкий И. С., см. Жалко-Титаренко И. В. 1, 180  
 Робенков А. Д., см. Веренчикова Р. Г. 6, 1008  
 Робенков А. Д., см. Водаков Ю. А. 1, 107  
 Робенков А. Д., см. Водаков Ю. А. 11, 1857  
 Рожков А. В., см. Аврутин Е. А. 4, 719  
 Рознован Ю. В., см. Арушанов Э. К. 2, 395  
 Ройцин А. Б., см. Кустов В. Е. 11, 1928  
 Ройцин А. Б., Пляцко С. В., Громовой Ю. С., Климов А. А., Кадышев С. К. Проявление механических напряжений в электронном парамагнитном резонансе гетеросистем на основе соединений  $Al^{IV}V^{VI}$ , легированных примесью марганца. 12, 2091  
 Романов А. В., см. Добровольский В. Н. 8, 1361  
 Романов В. А., см. Бабичев Г. Г. 7, 1244  
 Романов В. А., см. Бабичев Г. Г. 10, 1723  
 Романов В. А., см. Буанов А. В. 4, 629  
 Романов В. А., см. Гасан-заде С. Г. 6, 1100  
 Романов Ю. А., см. Алешкин В. Я. 2, 318  
 Рубец В. П., см. Беляев А. П. 5, 935  
 Рубец В. П., см. Беляев А. П. 10, 1755  
 Рувинсов С. С., см. Бочкарева Н. И. 5, 872  
 Рувинский М. А., см. Фреик Д. М. 12, 2103  
 Руденко А. С., см. Гродненский И. М. 9, 1521  
 Рудь В. Ю., см. Константинова Н. Н. 11, 1861  
 Рудь В. Ю., см. Константинова Н. Н. 3, 558  
 Рудь В. Ю., см. Магомедов М. А. 3, 556

- Рудь В. Ю., Рудь Ю. В., Сергинов М. Усиление фотоплеохроизма в структурах  $n-p-CdSiAs_2-n-In_2O_3$ . 3, 506
- Рудь Ю. В., см. Константинова Н. Н. 3, 558
- Рудь Ю. В., см. Константинова Н. Н. 11, 1861
- Рудь Ю. В., см. Магомедов М. А. 3, 556
- Рудь Ю. В., см. Магомедов М. А. 11, 1997
- Рудь Ю. В., см. Рудь В. Ю. 3, 506
- Румянцев В. Д., см. Казанцев А. Б. 9, 1666
- Румянцев С. Л., см. Гусинский Г. М. 3, 543
- Румянцев С. Л. Динамика включения Si и GaAsp-i-n-диодов. 11, 1955
- Румянцева С. М., см. Коваленко А. В. 7, 1251
- Русина М. В., см. Кашкаров П. К. 10, 1835
- Руссу Е. В., см. Ковалевская Г. Г. 10, 1750
- Руссу Е. В., см. Мередов М. М. 9, 1590
- Рут О. Э., см. Германенко А. В. 12, 2136
- Рыбак А. М., см. Гуга К. Ю. 12, 2141
- Рыжий В. И., см. Захарова А. А. 7, 1182
- Рыков В. В., Харионовский А. В., Вывенко О. Ф. Отрицательный фотоакустический эффект в стеклообразном селениде мышьяка. 9, 1653
- Рыльков В. В., см. Веденев А. С. 6, 1096
- Рыльков В. В., см. Ждан А. Г. 12, 2024
- Рябова Л. И., см. Белоконь С. А. 2, 264
- Сабирзянова Л. Д., см. Цидильковский И. М. 11, 1894
- Савельев И. Г., см. Крещук А. М. 8, 1375
- Савицкий А. В., Ткачук В. И., Ткачук П. Н. Электрические свойства экстрагированного теллурида кадмия. 5, 952
- Савицкий В. Г., Соколовский Б. С., Новак В. И. Рекомбинационное излучение варизонных полупроводников в условиях магнитоконцентрационного эффекта. 3, 571
- Салий Я. П., см. Фрейк Д. М. 12, 2103
- Салихов Х. М., см. Ковалевская Г. Г. 10, 1750
- Сальков Е. А., см. Бабенцов В. Н. 6, 1088
- Сальков Е. А., см. Бакши И. С. 1, 173
- Сальман Е. Г., см. Воронков В. П. 6, 1120
- Самойлюк Т. Т., см. Бумай Ю. А. 7, 1306
- Санкин В. И., см. Веренчикова Р. Г. 6, 1008
- Саруханян Р. Э., см. Арутюнян В. М. 3, 550
- Сафронов Л. Н., см. Герасименко Н. Н. 9, 1651
- Саченко А. В., см. Вуль А. Я. 2, 295
- Свечников С. В., см. Кириллова С. И. 8, 1399
- Свирида С. В., см. Водаков Ю. А. 11, 1857
- Свиридов В. В., см. Белявский В. И. 10, 1832
- Свительский А. В., см. Кладько В. П. 11, 1932
- Семенов В. В., см. Водаков Ю. А. 1, 107
- Семенов В. В., см. Водаков Ю. А. 11, 1857
- Семенов Ю. Г., Стефанович В. А. Энергия связи экситонов в магнитоселективных полупроводниках в магнитном поле. 2, 324
- Семенова Г. Н., см. Кладько В. П. 2, 368
- Семенова Г. Н., см. Кладько В. П. 11, 1932
- Семиколенова Н. А., см. Богданова В. А. 5, 818
- Сергинов М. М., см. Рудь В. Ю. 3, 506
- Сердюк В. В., см. Краснов А. Н. 6, 1151
- Серженко Ф. Л., Шадрин В. Д. Теория инфракрасных фотоприемников на основе структур  $n-Si-Si_{1-x}Ge_x$  с квантовыми ямами. 3, 491
- Сечкарев А. В., см. Берер В. Н. 5, 911
- Сизов Ф. Ф., см. Дарчук С. Д. 5, 845
- Сиповская М. А., см. Баранов А. Н. 9, 1612
- Сирохов У., см. Баграев Н. Т. 3, 427
- Сирохов У., см. Баграев Н. Т. 5, 836
- Скипетров Е. П., см. Брандт Н. Б. 5, 888
- Скопина В. И., см. Гуревич С. А. 1, 102
- Слепнев Ю. В., см. Гродненский И. М. 9, 1521
- Слободчиков С. В., см. Ковалевская Г. Г. 10, 1750
- Слободчиков С. В., см. Мередов М. М. 9, 1590
- Смекалин К. Е., см. Минтаиров А. М. 4, 614
- Смирнов А. Ю. Особенности дрейфа носителей тока, рассеивающихся на двумерных оптических фононах в сильнонеравновесном стационарном состоянии. 9, 1662
- Смирнов В. А., см. Андрухив А. М. 7, 1288
- Смирнов В. А., см. Георгиц Е. И. 1, 89
- Смирнов В. А., см. Иванов-Омский В. И. 2, 305
- Смиронов В. А., см. Иванов-Омский В. И. 3, 413
- Смирнов В. А., см. Иванов-Омский В. И. 3, 420
- Смирнов Д. В., см. Арушанов Э. К. 2, 395
- Смирнова Т. П., см. Воронков В. П. 6, 1120
- Смиян О. Д., см. Торчинская Т. В. 3, 454
- Собищанский Б. М., см. Махний В. П. 6, 1140
- Соболев М. М., Гитцович А. В., Папенцев М. И., Кочнев И. В., Явич Б. С. Механизм деградации (GaAs/AlGaAs)-лазера с квантовой ямой. 10, 1760
- Соболев Н. А., см. Выжигин Ю. В. 11, 1938
- Соботта Х., см. Сырбу Н. Н. 2, 232
- Соколов А. П., см. Голикова О. А. 5, 960
- Соколов В. И., см. Водаков Ю. А. 1, 107
- Соколов В. И., см. Водаков Ю. А. 11, 1857
- Соколовский Б. С., см. Монастырский Л. С. 12, 2143
- Соколовский Б. С., см. Савицкий В. Г. 3, 571
- Соловьева А. Е. Образование шнура проводимости и пробоя в поликристаллическом оксиде индия. 3, 408
- Сорока В. И., Арцимович М. В., Могильник И. Ф. Угол связи Si—O—Si в монокристалле кремния. 9, 1547
- Сорокина К. Л. Влияние статического сдвига уровня Ферми на электропроводность  $a-Si$ : H нормальное и аномальное правило Мейра—Неделла. 8, 1500
- Сорокина К. Л., см. Голикова О. А. 8, 1511
- Сосновский В. Р., см. Аверкиев Н. С. 7, 1269
- Стамов И. Г., см. Сырбу Н. Н. 4, 669
- Стамов И. Г., см. Сырбу Н. Н. 7, 1191
- Становов О. Н., см. Айвазов А. А. 9, 1585



- Старосельцева С. П., см. Баранов А. Н. 9, 1612
- Старостин К. В., см. Гродненский И. М. 9, 1521
- Стафеев В. И., см. Абрамян Ю. А. 2, 257
- Стафеев В. И., см. Горшкова О. В. 3, 510
- Стафеев В. И., см. Мухитдинов А. М. 10, 1830
- Степанова М. Н., см. Ильинский А. В. 4, 710
- Стефанович В. А., см. Семенов Ю. Г. 2, 324
- Стоянова И. Г., см. Абрамов А. А. 3, 500
- Стратан Г. И., см. Сырбу Н. Н. 1, 74
- Страхов Л. П., см. Давыдов И. А. 1, 159
- Стрельчук В. В., см. Артамонов В. В. 4, 725
- Строкан Н. Б., см. Вербицкая Е. М., см. 11, 1962
- Строкан Н. Б., см. Еремин В. К. 3, 477
- Стрэдлинг Р. А., см. Иванов-Омский В. И. 3, 413
- Стусь Н. М., см. Айдаралиев М. Ш. 2, 246
- Стусь Н. М., см. Гусев О. Б. 4, 738
- Стусь Н. М., см. Кудрявцев Ю. А. 10, 1742
- Стяпонавичус А. А., см. Зуев В. В. 1, 171
- Субашиев А. В., см. Герчиков Л. Г. 1, 131
- Субашиев А. В., см. Герчиков Л. Г. 5, 882
- Султанов А. М., см. Аврутин Е. А. 4, 719
- Сумарока А. М., см. Гольдман Е. И. 12, 2048
- Суслов Л. А., см. Бедный Б. И. 11, 1984
- Сыралев В. А., см. Водаков Ю. А. 1, 107
- Сырбу Н. Н. Влияние нарушения стехиометрии на экситонные, электронные и колебательные состояния в дифосфиде цинка. 6, 1069
- Сырбу Н. Н., Камерцель А. Ю., Стамов И. Г. Особенности валентных зон некоторых соединений А<sup>IV</sup>В<sup>IV</sup>. 4, 669
- Сырбу Н. Н., Львин В. Э., Заднипру И. Б., Ноймаш Х., Соббота Х., Риеде В. Романовские и ИК колебательные спектры в кристаллах TlGaS<sub>2</sub>. 2, 232
- Сырбу Н. Н., Морозова В. И., Стратан Г. И. Поглощения на связанных и свободных экситонах в ZnP<sub>2</sub>-D<sub>2</sub><sup>h</sup>. 1, 74
- Сырбу Н. Н., Пасечник Ф. И. Колебательные спектры и эффективные ионные заряды в кристаллах AgAsS<sub>2</sub> и TlAsS<sub>2</sub>. 10, 1701
- Сырбу Н. И., Стамов И. Г., Камерцель А. Ю. Свойства поверхности и структура энергетических зон соединений А<sup>IV</sup>В<sup>IV</sup> симметрий D<sub>2d</sub><sup>h</sup> и C<sub>2v</sub><sup>h</sup>. 7, 1191
- Сырбу Н. Н., Тэзлован В. Е., Заднипру И. Б. Деполаризация колебательных мод в кристаллах CdGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub>. 7, 1225
- Сыродоев Г. А., см. Крючков С. В. 4, 774
- Тагер А. С., см. Кальфа А. А. 5, 896
- Тагер А. С., см. Кальфа А. А. 9, 1574
- Тагиев О. Б., см. Асланов Г. К. 4, 703
- Талалакин Г. Н., см. Айдаралиев М. Ш. 2, 246
- Талипов Н. Х., Попов В. П., Ремесник В. Г., Налькина З. А. Влияние отжига под анодным окислом на изменение состава поверхности и конверсию типа проводимости монокристаллов p-Cd<sub>x</sub>Hg<sub>1-x</sub>Te (x ≈ 0.2). 5, 310
- Тамендаров М. Ф., см. Мукашев Б. Н. 6, 1124
- Танклевская Е. М., см. Казанцев А. Б. 9, 1666
- Тарапов С. И., см. Вертий А. А. 4, 585
- Тарбаев Н. И., см. Бабенцов В. Н. 6, 1088
- Тарнавский С. П., см. Гергель В. А. 7, 1330
- Тарнавский С. П., см. Гергель В. А. 7, 1335
- Таурбаев Т. И., см. Манаков С. М. 6, 1145
- Тевзадзе Г. А., см. Карумидзе Г. С. 12, 2138
- Теплицкий В. А., см. Крюкова И. В. 6, 1054
- Тесленко В. В., см. Петренко Т. Л. 9, 1556
- Тетьльбаум Д. И., см. Лобанова Н. Е. 8, 1514
- Тешабаев А., см. Абдураимов А. 10, 1845
- Тимофеев А. Б., см. Абрамов В. В. 5, 878
- Тимофеев А. Б., см. Кульбачинский В. А. 10, 1801
- Тимошенко В. Ю., см. Кашкаров П. К. 7, 1321
- Тимошенко В. Ю., см. Кашкаров П. К. 10, 1835
- Тихомиров В. К. Фотоиндуцированные эллиптические двулучепреломление и дихроизм в стеклообразных полупроводниках. 8, 1415
- Тихомирова В. А., см. Баранов А. Н. 9, 1612
- Тишковский Е. Г., см. Чистохин И. Б. 9, 1529
- Тищенко В. В., см. Коваленко А. В. 7, 1251
- Ткачук В. И., см. Савицкий А. В. 5, 952
- Ткачук Н. П., см. Савицкий А. В. 5, 952
- Токмолдин С. Ж., см. Мукашев Б. Н. 6, 1124
- Толбанов О. П., см. Хлудков С. С. 2, 386
- Толстихин В. И., см. Долманов И. Н. 11, 1899
- Толстихин В. И., см. Пицалко В. Д. 4, 602
- Толстых В. П., см. Носиков А. П. 10, 1841
- Торопов А. И., см. Гусев Г. М. 3, 539
- Торопов А. И., см. Шегай О. А. 11, 1987
- Торопов А. И., см. Шегай О. А. 11, 1989
- Торчинская Т. В., Бердинских Т. Г., Смирян О. Д. Природа нестабильности свечения в светоизлучающих GaP: N-структурах. 3, 454
- Тошходжаев Х. А., см. Беляев А. П. 5, 935
- Тошходжаев Х. А., см. Беляев А. П. 10, 1755
- Трипаченко Н. А., см. Кустов В. Е. 11, 1928
- Трифоненков В. П., см. Выборнов В. В. 12, 2076
- Трифонова М. М., Барышев Н. С., Мезенцева М. П., Ахмедова Ф. И., Аверьянов И. С. Электрические свойства эпитаксиальных слоев марганец—ртуть—теллур р-типа. 7, 1327
- Трофимов В. Т., см. Засавицкий И. И. 12, 2031
- Трусова И. А., Поляков М. Е. Дислокации в AlGaAs/GaAs-сверхрешетке. 6, 979
- Тысченко И. Е., см. Качурин Г. А. 8, 1390
- Тысченко И. Е., см. Качурин Г. А. 11, 1978

Гезлован В. Е., см. Сырбу Н. Н. 7, 1225  
Тюрин А. В., см. Бурлак А. В. 3, 548  
Тютерев В. Г., см. Даварашвили О. И. 5, 906

Удальцов В. Е., см. Водаков Ю. А. 1, 107  
Уколов А. Т., см. Горев Н. Б. 5, 861  
Уколов А. Т., см. Горев Н. Б. 7, 1339  
Ульяшин А. Г., см. Абрамов В. В. 5, 878  
Ульяшин А. Г., см. Бумай Ю. А. 7, 1306  
Ульяшин А. Г., см. Кульбачинский В. А. 10, 1801  
Уразбаева К. Т., см. Алексеева Г. Т. 2, 358  
Урманов Н. А. Релаксация емкости в  $n$ - $\pi$ - $\pi$ - $p$ -переходе с произвольным уровнем легирования  $n$ - и  $p$ -области. 9, 1635  
Урманов Н. А. Анализ температурной зависимости импеданса диода с неоднородной базой из перекompенсированного полупроводника. 9, 1669  
Урманов Н. А. Немонотонная изотермическая релаксация тока в  $n$ - $\pi$ - $p$ -структуре, связанная с инверсией электрического поля. 9, 1671  
Усманов М. М., см. Идлис Б. Г. 2, 329  
Устинов В. М.; см. Алфёров Ж. И. 10, 1715  
Устинов В. М., см. Минтаиров А. М. 4, 614  
Утенко В., см. Йодказис А. 8, 1394  
Ушаков В. В., см. Гукасян А. М. 3, 525

Феокистов Н. А., см. Жерздев А. Б. 4, 750  
Фергюсон И., см. Иванов-Омский В. И. 3, 413  
Фетисова В. А., см. Ковалевская Г. Г. 10, 1750  
Фидря Н. А., см. Бобицкий Я. В. 10, 1688  
Фидря Н. А., см. Венгер Е. Ф. 2, 352  
Филатов И. И., см. Горфинкель В. Б. 3, 401  
Филиков В. А., см. Лигачев В. А. 9, 1540  
Фомичев С. И., см. Кадушкин В. И. 5, 811  
Франкевич Е. Л., см. Кадыров Д. И. 2, 373  
Французов А. А., см. Охонин С. А. 5, 832  
Фреик А. Д., см. Фреик Д. М. 12, 2103  
Фреик Д. М., Салий Я. П., Рувинский М. А., Горичок И. Я., Фреик А. Д., Добровольская А. М. Образование и отжиг радиационных дефектов в пленках  $p$ -Pb<sub>0.76</sub>Sn<sub>0.24</sub>Te при протонном облучении. 12, 2103  
Фридрих Е. С., см. Буянов А. В. 4, 629  
Фролов В. Д., см. Идлис Б. Г. 1, 187  
Фукс Б. И., см. Винокуров Л. А. 4, 770

Хабибуллаев П. К., см. Закиров А. С. 7, 1282  
Хазан Л. С., см. Кладько В. П. 2, 368  
Ханкина С. И., см. Басс Ф. Г. 1, 140  
Харионовский А. В., см. Рыков В. В. 9, 1653  
Харченко В. А., см. Иванов-Омский В. И. 10, 1728  
Харченко Т. Д., см. Алимов О. М. 11, 1914  
Хвостиков В. П., см. Казанцев А. Б. 9, 1666  
Хвостиков В. П., см. Минтаиров А. М. 4, 614

Хижняк Б. И., см. Бакии И. С. 1, 173  
Химматкулов О., см. Абдураимов А. 10, 1845

Хлудков С. С., Толбанов О. П. Механизм высокоскоростного переключения в арсенид-галлиевых структурах с глубокими центрами. 2, 386  
Хляп Г. М., см. Андрухив М. Г. 4, 761  
Холоднов В. А., см. Блохин И. К. 4, 742  
Хорош А. Г., см. Брандт Н. Б. 5, 888  
Хохлов Д. Р., см. Белоконов С. А. 2, 264  
Хохлов Д. Р., см. Де Виссер А. 6, 1034  
Хохлов Д. Р., Чесноков С. Н. Релаксация задержанной фотопроводимости в электрическом поле в сплавах Pb<sub>1-x</sub>Sn<sub>x</sub>Te(In). 6, 1135

Царенков Г. В., см. Абакумов В. Н. 2, 284  
Царенков Г. В., см. Кашерининов П. Г. 8, 1480  
Целищев С. Л., см. Давыдов И. А. 1, 159  
Цидильковский И. М., Леринман Н. К., Сабирзянова Л. Д., Паранчич С. Ю., Паранчич Ю. С. Резонансные состояния, образованные примесями кобальта и никеля в селениде ртути. 11, 1894  
Цидильковский Э. И., см. Андрухив А. М. 7, 1288  
Цукерман В. Г., см. Бурлак А. В. 3, 548  
Цыпешка Д. И., см. Иванов-Омский В. И. 10, 1728

Чайкина Е. И., см. Кудрявцев Ю. А. 10, 1742  
Чалдышев В. В., см. Акчурин Р. Х. 8, 1409  
Чалдышев В. В., см. Пышная Н. Б. 10, 1737  
Чалботарь В. И., см. Коварский В. А. 10, 1828  
Чепик Д. И., см. Гуревич С. А. 1, 102  
Черник И. А., см. Березин А. В. 8, 1405  
Чернобай В. А., см. Кириллова С. И. 8, 1399  
Чернышов В. Н., см. Гриняев С. Н. 12, 2057  
Чесноков С. Н., см. Хохлов Д. Р. 6, 1136  
Чикун В. В., см. Кальфа А. А. 6, 1024  
Чистохин И. Б., Тишковский Е. Г., Герасименко Н. Н. Неустойчивости тока в фотосопроотивлении на основе кремния, легированного селеном. 9, 1529  
Чистяков В. М., см. Ясиевич И. Н. 10, 1815  
Чулков Е. В., см. Королева О. С. 2, 223  
Чумак В. А., см. Пышная Н. Б. 10, 1737  
Чуприков Н. Л. Матрица переноса одномерного уравнения Шредингера 12, 2040

Шавелашвили Ш. Ш., см. Карумидзе Г. С. 12, 2138  
Шадрин В. Д., см. Серженко Ф. Л. 3, 491  
Шатров В. И., см. Качурин Г. А. 11, 1978  
Шафран А. Г., см. Веденев А. С. 6, 1096  
Шабовцов В. И., см. Кустов В. Е. 11, 1928  
Шеханин А. П., см. Голикова О. А. 5, 960  
Шевченко Б. Н., см. Александров О. В. 5, 868  
Шегай О. А., Мошегов Н. Т., Палкин А. М., Горопов А. И. Циклотронный резонанс

- нанс в сверхрешетках (GaAs)<sub>2</sub>(InAs)<sub>m</sub>. 11, 1987
- Шегай О. А., Мошегов Н. Т., Палкин А. М., Торопов А. И. Спектр состояний мелкого донора в сверхрешетках (GaAs)<sub>2</sub>(InAs)<sub>m</sub>. 11, 1989
- Шейнкман М. К., см. Панов В. П. 1, 95
- Шек Е. И., см. Выжигин Ю. В. 11, 1938
- Шемелина О. С., Новотоцкий-Власов Ю. Ф. Равновесные параметры глубоких объемных уровней в антимониде индия. 6, 1015
- Шеметило Д. И., см. Кардо-Сысоев А. Ф. 6, 1048
- Шепельский Г. А., см. Буянов А. В. 4, 629
- Шапельский Г. А., см. Гасан-заде С. Г. 6, 1100
- Шерегий Е. М., см. Вирт И. С. 3, 562
- Шерстнев В. В., см. Баранов А. Н. 9, 1612
- Шик А. Я. Краевая энергетическая релаксация в квантовом эффекте Холла. 5, 955
- Шик А. Я. Полупроводниковые структуры с δ-слоями (обзор). 7, 1161
- Шик А. Я., см. Петросян С. Г. 4, 763
- Шикин В. Б., см. Шикина Ю. В. 6, 992
- Шикин В. Б., см. Шикина Ю. В. 6, 997
- Шикина Ю. В., Шикин В. Б. Нелинейные свойства ВАХ и ВФХ для стенки из заряженных дислокаций. 6, 992
- Шикина Ю. В., Шикин В. Б. Об акцепторно-донорных свойствах дислокаций в полупроводниках р-типа. 6, 997
- Шишкин А. В., см. Водаков Ю. А. 11, 1857
- Шкумбатьюк П. С., см. Андрухив М. Г. 2, 393
- Шкумбатьюк П. С., см. Андрухив М. Г. 4, 761
- Шкумбатьюк П. С., см. Вирт И. С. 3, 562
- Шлопак Н. В., см. Бумай Ю. А. 7, 1306
- Шлопак Н. В., см. Кульбачинский В. А. 10, 1801
- Шмагин В. Б., см. Гордеев Д. М. 5, 955
- Шмальц К., см. Болотов В. В. 7, 1295
- Шмарцев Ю. В., см. Голубев В. Г. 3, 574
- Шмарцев Ю. В., см. Пышная Н. Б. 10, 1737
- Шматов А. А. К вопросу о корреляционной функции в релаксационной спектроскопии глубоких уровней. 3, 473
- Шмелев С. С., см. Игнатьев А. С. 10, 1795
- Шотов А. П., см. Бычкова Л. П. 2, 280
- Штельмах К. Ф., см. Георгиц Е. И. 1, 89
- Шубин В. С., см. Игнатьев А. С. 10, 1795
- Шубников М. Л., см. Арушанов Э. К. 2, 395
- Шульга Е. П., см. Крюкова И. В. 6, 1054
- Шульга М. И., см. Дмитриев А. Г. 2, 397
- Шульга Т. С., см. Грибковский В. П. 11, 1920
- Шустров Б. А., см. Козловский В. В. 1, 3
- Шуша В. В., см. Колковский И. И. 1, 176
- Щамхалов К. С., см. Гергель В. В. 5, 794
- Щекочихин Ю. М., см. Коваленко А. В. 7, 1251
- Эйдельман Б. Л., см. Короткевич А. В. 5, 942
- Эмексузян В. М., см. Болотов В. В. 7, 1295
- Эппель В. И., см. Горев Н. Б. 7, 1339
- Юлдашев Ш. У., см. Андрухив А. М. 7, 1288
- Юлдашев Ш. У., см. Иванов-Омский В. И. 3, 413
- Юлдашев Ш. У., см. Иванов-Омский В. И. 3, 420
- Юсупов А., см. Баграев Н. Т. 3, 427
- Юсупов А., см. Баграев Н. Т. 3, 481
- Юсупов А., см. Баграев Н. Т. 5, 836
- Юхимчук В. А., см. Артамонов В. В. 4, 725
- Яблонский Г. П., см. Грибковский В. П. 11, 1920
- Явид В. Ю., см. Алимов О. М. 11, 1914
- Явич Б. С., см. Соболев М. М. 10, 1760
- Яковлев М. П., см. Зуев В. В. 1, 171
- Яковлев Ю. П., см. Баранов А. Н. 11, 1971
- Янькова Т. Н., см. Алешкин В. Я. 3, 516
- Яржембицкий В. Б., см. Гусев О. К. 6, 1138
- Яссен М. Л., см. Гродненский И. М. 9, 1521
- Яссиевич И. Н., см. Бумялене С. 9, 1569
- Яссиевич И. Н., Чистяков В. М. Неравновесное распределение дефектов по энергиям колебаний при многофононной рекомбинации. 10, 1815
- Ястребов С. Г., см. Иванов-Омский В. И. 2, 305
- Яфяев Р. Р., см. Голикова О. А. 1, 66
- Яфясов А. М., Перепелкин А. Д., Божевольнов В. Б. Исследование параметров зонной структуры приповерхностных слоев бесщелевых полупроводников (CdHg)Te и HgTe методом эффекта поля в электролитах. 4, 636